8位微控制器

CMOS

F2MC-8FX MB95330H 系列

MB95F332H/F332K/F333H/F333K/F334H/F334K

■ 概要

MB95330H 系列是通用单芯片微控制器产品。该系列既内置精简指令集又包含多种外设功能。注:F²MC 是 FUJITSU Flexible Microcontroller 的缩写。

■ 特征

- F2MC-8FX CPU 内核
 - 控制器最优化指令集
 - 乘除指令
 - 16 位算术运算
 - 位测试跳转指令
 - 位操作指令等
- 时钟
 - 可选择主时钟源
 - 主 OSC 时钟 (高达 16.25 MHz, 最大机器时钟频率: 8.125 MHz)
 - 外部时钟 (高达 32.5 MHz,最大机器时钟频率:16.25 MHz)
 - 主 CR 时钟 (1/8/10/12.5 MHz ±2%, 最大机器时钟频率: 12.5 MHz)
 - 可选择副时钟源
 - 副 OSC 时钟 (32.768 kHz)
 - 外部时钟 (32.768 kHz)
 - 副 CR 时钟 (典型值: 100 kHz, 最小值: 50 kHz, 最大值: 200 kHz)
- 定时器
 - 8/16 位多功能定时器×2 路通道
 - 8/16 位 PPG×3 路通道
 - 16 位 PPG×1 路通道 (既可单独运行也可与多脉冲发生器共同运行)
 - 16 位重载定时器×1 路通道(既可单独运行也可与多脉冲发生器共同运行)
 - 时基定时器 × 1 路通道
 - 计时预分频器×1 路通道
- UART/SIO × 1 路通道
 - 全双工双缓冲器
 - 支持时钟异步 (UART) 和时钟同步 (SIO) 传输串行数据

(转下页)

如需有关微控制器支持的信息,请访问以下网站:

http://edevice.fujitsu.com/micom/en-support/



(承上页)

- I2C×1 路通道
 - 内置唤醒功能
- 多脉冲发生器 (MPG)(用于 DC 马达控制)×1路通道
 - 16 位重载定时器×1 路通道
 - 16 位 PPG 定时器 × 1 路通道
 - 序列波形发生器(含16位定时器(内置缓冲器和比较清零功能))
- LIN-UART
 - 全双工双缓冲器
 - 支持时钟同步/时钟异步传输串行数据
- 外部中断×10 路通道
 - 沿检测中断(可选择上升沿、下降沿或双沿)
 - 支持从低功耗(待机)模式中唤醒器件
- 8/10 位 A/D 转换器×8 路通道
 - 可选择 8 位 /10 分辨率
- 低功耗 (待机) 模式
 - 停止模式
 - 休眠模式
 - 计时模式
 - 时基定时器模式
- I/O □
 - MB95F332H/F333H/F334H(最多 I/O □数:28 个)

通用 I/O 口 (N-ch 开漏): 3 个

通用 I/O 口 (CMOS I/O): 25 个

• MB95F332K/F333K/F334K (最多 I/O 口数: 29 个)

通用 I/O 口 (N-ch 开漏): 4 个 通用 I/O 口 (CMOS I/O): 25 个

- 片内调试
 - 单线串行控制
 - 支持串行编程(异步模式)
- 硬件 / 软件监视定时器
 - 内置硬件监视定时器
- 低压检测复位电路
 - 内置低压检测器
- 时钟监视计数器
 - 内置时钟监视计数器功能
- 可编程端口输入电压电平
 - CMOS 输入电平 / 迟滞输入电平
- 双操作闪存
 - 支持在不同的寄存器组(高位组/低位组)内执行擦/写操作和读取操作
- 闪存加密功能
 - 保护闪存数据

■ 产品阵容

产品型号										
	MB95F332H	MB95F333H	MB95F334H	MB95F332K	MB95F333K	MB95F334K				
参数										
类型			闪存	产品						
时钟监视计数 器	监控主时钟振荡	控主时钟振荡。								
程序 ROM 容量		12 KB	20 KB	8 KB	12 KB	20 KB				
RAM 容量	240 B	496 B	1008 B	240 B	496 B	1008 B				
低压检测复位		无			有					
复位输入		专用			软件选择					
CPU 功能	指令位长 指令长度 数据位长	指令长度 : 1~3个字节 数据位长 : 1,8 和 16 位 最短指令执行时间 : 61.5 ns (机器时钟频率 = 16.25 MHz)								
通用 I/O		I/O 口 (最多): 28 个 CMOS I/O: 25 个 I/O 口 (最多): 29 个 CMOS I/O: 25 个								
时基定时器	中断周期: 0.25	6 ms ~ 8.3 s (⁄	外部时钟频率 =	4 MHz 时)						
硬件/软件监视 定时器		0 MHz 时 : 105]作硬件监视定时								
Wild 寄存器	可用于替换3个	>字节的数据。								
LIN-UART	支持时钟同步/	定时器选择广泛时钟异步传输串 时钟异步传输串 LIN 主控端或 L	3行数据。	速度。						
o, . o , , _ _ ,	8 路通道									
换器	可选择8位/10位分辨率。									
	2 路通道	2 路通道								
8/16 位多功能 定时器										
	10 路通道									
外部中断	沿检测中断(可选择上升沿、下降沿或双沿) 可用于从各待机模式中唤醒器件。									
片内调试	单线串行控制 支持串行编程。	(异步模式)								

(承上页)

(承上欠)											
产品型号											
	MB95F332H	MB95F333H	MB95F334H	MB95F332K	MB95F333K	MB95F334K					
参数											
	1 路通道										
UART/SIO	具有全双工双缘 支持使用 NRZ 支持 LSB/MSB	支持通过 UART/SIO 方式传输数据。 具有全双工双缓冲器、可变数据长 (5/6/7/8 位)、内置波特率发生器和错误检测功能。 支持使用 NRZ 型传输格式。 支持 LSB/MSB 数据传输 支持时钟异步 (UART) 和时钟同步 (SIO) 传输串行数据。									
	1 路通道										
I ² C	主控/从动收/ 具有总线报错功 具有生成/检测	」能、仲裁功能、	传输方向检测: 条件的功能。	功能和唤醒功能	0						
	3 路通道										
8/16 位 PPG	PPG 的各通道可从八个时钟源			个 16 位 PPG 通	i道。						
16 位 PPG	可使用 PWM 模式和单次模式。 可从八个时钟源中选择计数器工作时钟。 支持外部触发启动。 既可单独运行也可与多脉冲发生器共同运行。										
16 位重载定时 器	可使用两个时钟模式和两个计数器工作模式。 支持输出方波。 计数时钟:可从内部时钟(七种类型)和外部时钟中选择。 两个计数器工作模式:重载模式和单次模式 既可单独运行也可与多脉冲发生器共同运行。										
多脉冲发生器(用于 DC 马达 控制)	16 位 PPG 定时器:1 路通道 16 位重载定时器操作: 跳转输出、单次输出 事件计数器:1 路通道 序列波形发生器(含16 位定时器(内置缓冲器和比较清零功能))										
计时预分频器	可选择八种不同]的时间间隔。									
闪存	支持自动编程、嵌入算法、写 / 擦 / 擦除暂停 / 擦除恢复命令。 具有表示嵌入算法操作完成的标志。 写 / 擦周期数: 100,000 次 数据保持时间: 20 年 具有保护闪存数据的闪存加密功能										
待机模式	休眠模式、停止	休眠模式、停止模式、计时模式、时基定时器模式									
封装	FPT-32P-M30 DIP-32P-M06 LCC-32P-M19										

■ 封装及相应产品

产品型号	MB95F332H	MB95F332K	MB95F333H	MB95F333K	MB95F334H	MB95F334K
FPT-32P-M30	0	0	0	0	0	0
DIP-32P-M06	0	0	0	0	0	0
LCC-32P-M19	0	0	0	0	0	0

O: 支持

■ 产品差异和产品选择注意事项

• 功耗

使用片内调试功能时,注意闪存擦/写时的功耗。 关于功耗的详细信息,参考"■ 电气特性"。

封装

关于各封装的详细信息,参考"■封装及相应产品"和"■封装尺寸"。

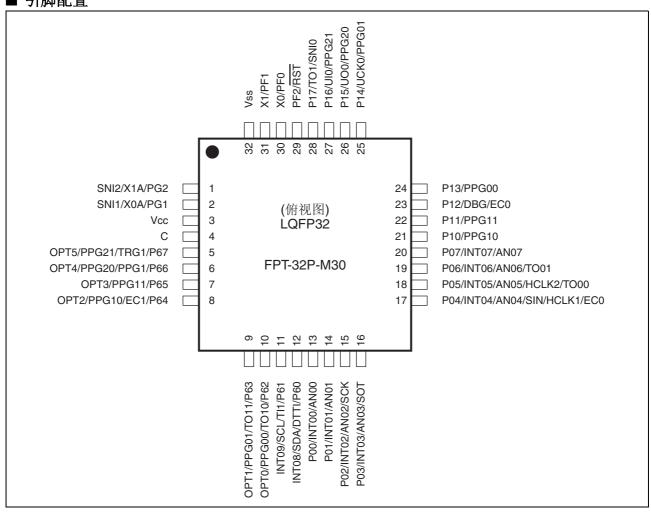
•工作电压

工作电压取决于是否使用片内调试功能。 关于工作电压的详细信息,参考 ■ 电气特性 "。

• 片内调试功能

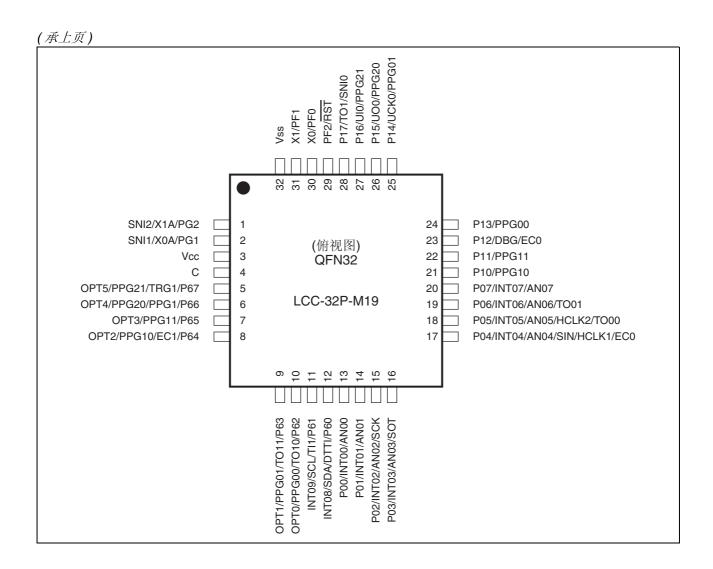
片内调试功能要求将 Vcc, Vss 和串行单线连接至评估工具。

■ 引脚配置



PF2/RST	(俯视图) SH-DIP32 DIP-32P-M06	32 P17/TO1/SNI0 31 P16/UI0/PPG21 30 P15/UO0/PPG20 29 P14/UCK0/PPG01 28 P13/PPG00 27 P12/DBG/EC0 26 P11/PPG11 25 P10/PPG10 24 P07/INT07/AN07 23 P06/INT06/AN06/TO01 22 P05/INT05/AN05/HCLK2/TO00 21 P04/INT04/AN04/SIN/HCLK1/EC0 20 P03/INT03/AN03/SOT 19 P02/INT02/AN02/SCK 18 P01/INT01/AN01 17 P00/INT00/AN00
---------	----------------------------------	---

8



■ 引脚说明

引脚号			LO HIB												
LQFP32*1& QFN32*2	SH-DIP32*3	引脚名称	I/O 电路 类型* ⁴	功能描述											
		PG2		通用 I/O 口											
1	5	X1A	С	副时钟 I/O 振荡引脚											
		SNI2		MPG 序列波形发生器的位置检测功能用的触发输入引脚											
		PG1		通用 I/O 口											
2	6	X0A	С	副时钟输入振荡引脚											
		SNI1		MPG 序列波形发生器的位置检测功能用的触发输入引脚											
3	7	Vcc	_	电源引脚											
4	8	С	_	电容器连接引脚											
		P67		通用 I/O 口 大电流端口											
5	9	PPG21	D	8/16 位 PPG ch. 2 输出引脚											
		TRG1		16 位 PPG ch. 1 触发输入引脚											
		OPT5	ļ	MPG 序列波形发生器输出引脚											
	10	P66		通用 I/O 口 大电流端口											
6		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PPG20	PPG20 D	8/16 位 PPG ch. 2 输出引脚
			PPG1		16 位 PPG ch. 1 输出引脚										
		OPT4		MPG 序列波形发生器输出引脚											
_	11	P65		通用 I/O 口 大电流端口											
7	11	PPG11	D	8/16 位 PPG ch. 1 输出引脚											
		OPT3		MPG 序列波形发生器输出引脚											
		P64		通用 I/O 口 大电流端口											
8	12	EC1	D	8/16 位多功能定时器 ch. 1 时钟输入引脚											
		PPG10		8/16 位 PPG ch. 1 输出引脚											
		OPT2		MPG 序列波形发生器输出引脚											
		P63		通用 I/O 口 大电流端口											
9	13	TO11	l D	8/16 位多功能定时器 ch. 1 输出引脚											
		PPG01		8/16 位 PPG ch. 0 输出引脚											
		OPT1		MPG 序列波形发生器输出引脚											

引服	# 号			
LQFP32*1& QFN32*2	SH-DIP32*3	引脚名称	I/O 电路 类型* ⁴	功能描述
		P62		通用 I/O 口 大电流端口
10	14	TO10	D	8/16 位多功能定时器 ch. 1 输出引脚
		PPG00		8/16 位 PPG ch. 0 输出引脚
		OPT0		MPG 序列波形发生器输出引脚
		P61		通用 I/O 口
11	15	INT09	ı	外部中断输入引脚
''	13	SCL	'	I ² C 时钟 I/O 引脚
		TI1		16 位重载定时器 ch. 1 输入引脚
		P60		通用 I/O 口
12	16	INT08	ı	外部中断输入引脚
12	10	SDA		I ² C 数据 I/O 引脚
		DTTI		MPG 序列波形发生器输入引脚
	17	P00	E	通用 I/O 口
13		INT00		外部中断输入引脚
		AN00		A/D 转换器模拟输入引脚
	18	P01	E	通用 I/O 口
14		INT01		外部中断输入引脚
		AN01		A/D 转换器模拟输入引脚
	19	P02		通用 I/O 口
15		INT02	E	外部中断输入引脚
15		AN02	L	A/D 转换器模拟输入引脚
		SCK		LIN-UART 时钟 I/O 引脚
		P03		通用 I/O 口
16	20	INT03	E	外部中断输入引脚
10	20	AN03		A/D 转换器模拟输入引脚
		SOT		LIN-UART 数据输出引脚
		P04		通用 I/O 口
17		INT04		外部中断输入引脚
	21	AN04	F	A/D 转换器模拟输入引脚
"	۷۱	SIN	r	LIN-UART 数据输入引脚
		HCLK1		外部时钟输入引脚
		EC0		8/16 位多功能定时器 ch. 0 时钟输入引脚

引服	引脚号						
LQFP32*1& QFN32*2	SH-DIP32*3	引脚名称	I/O 电路 类型* ⁴	功能描述			
		P05		通用 I/O 口			
		INT05	-	外部中断输入引脚			
18	22	AN05	E	A/D 转换器模拟输入引脚			
		HCLK2	-	外部时钟输入引脚			
		TO00	-	8/16 位多功能定时器 ch. 0 输出引脚			
		P06		通用 I/O 口			
40	00	INT06	_	外部中断输入引脚			
19	23	AN06	E	A/D 转换器模拟输入引脚			
		TO01		8/16 位多功能定时器 ch. 0 输出引脚			
		P07		通用 I/O 口			
20	24	INT07	E	外部中断输入引脚			
		AN07		A/D 转换器模拟输入引脚			
0.4	05	P10	0	通用 I/O 口			
21	25	PPG10	G	8/16 位 PPG ch. 1 输出引脚			
00	26	P11 PPG11	G	通用 I/O 口			
22				8/16 位 PPG ch. 1 输出引脚			
		P12	Н	通用 I/O 口			
23	27	DBG		DBG 输入引脚			
		EC0		8/16 位多功能定时器 ch. 0 时钟输入引脚			
24	28	P13		通用 I/O 口			
24	20	PPG00	G	8/16 位 PPG ch. 0 输出引脚			
		P14		通用 I/O 口			
25	29	UCK0	G	UART/SIO ch. 0 时钟 I/O 引脚			
		PPG01		8/16 位 PPG ch. 0 输出引脚			
		P15		通用 I/O 口			
26	30	UO0	G	UART/SIO ch. 0 数据输出引脚			
		PPG20		8/16 位 PPG ch. 2 输出引脚			
		P16		通用 I/O 口			
27	31	UI0	J	UART/SIO ch. 0 数据输入引脚			
		PPG21		8/16 位 PPG ch. 2 输出引脚			
		P17		通用 I/O 口			
28	32	TO1	G	16 位重载定时器 ch. 1 输出引脚			
		SNI0		MPG 序列波形发生器的位置检测功能用的触发输入引脚			
		PF2		通用 I/O 口			
29	1	RST	Α	复位引脚 MB95F332H/F333H/F334H 的专用复位引脚			

(转下页)

11

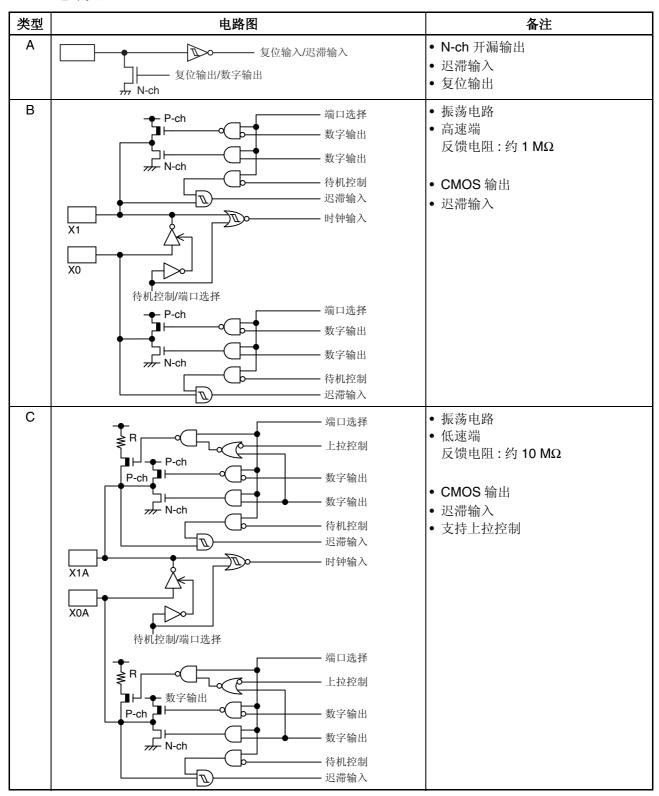
(承上页)

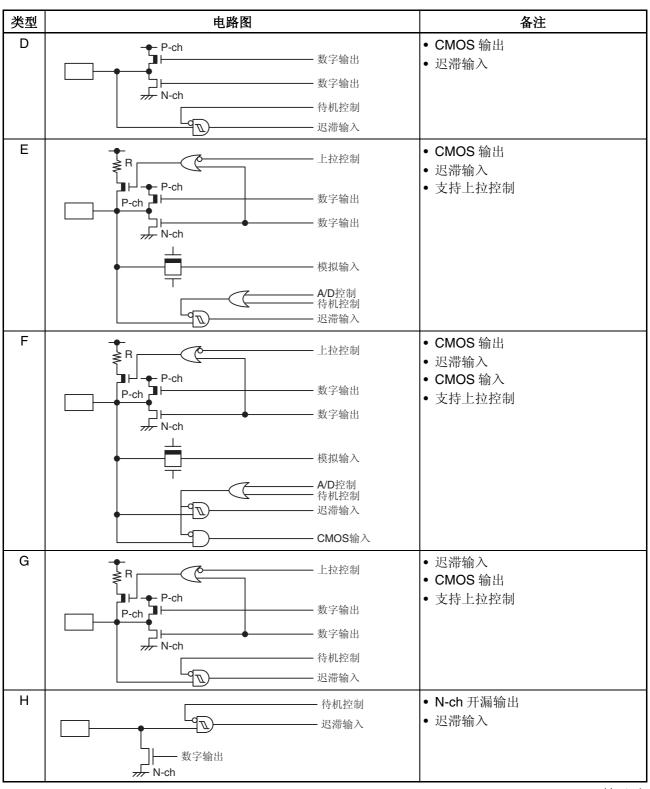
		-		-		
引脚号			I/O 电路			
LQFP32*1& QFN32*2	SH-DIP32*3	引脚名称	类型*⁴	功能描述		
30	2	PF0	В	通用 I/O 口		
30		X0		主时钟输入振荡引脚		
31	3	PF1	В	通用 I/O 口		
31	3	X1 B		主时钟 I/O 振荡引脚		
32	4	Vss	_	电源引脚 (GND)		

*1: 封装代码: FPT-32P-M30 *2: 封装代码: LCC-32P-M19 *3: 封装代码: DIP-32P-M06

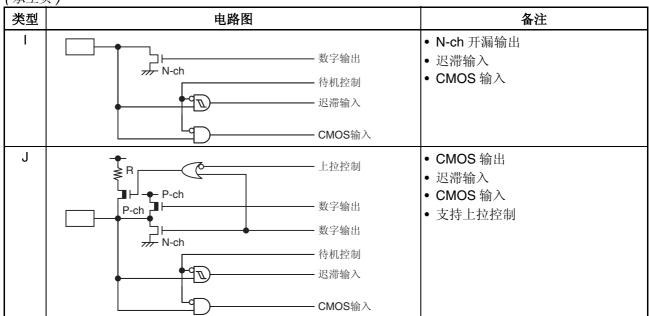
*4: 关于 I/O 电路类型,参考 "■ I/O 电路类型 "。

■ I/O 电路类型





(承上页)



■ 关于器件的使用注意事项

• 防止闩锁现象

使用器件时,确保施加电压不超过最大电压额定值。

在 CMOS IC 中,如果将高于 Vcc 引脚的电压或低于 Vss 引脚的电压施加到非中高耐压的输入 / 输出引脚,或将超出电源电压额定范围的电压 ("■ 电气特性 " 的 "1. 最大绝对额定值 ") 施加到 Vcc 引脚或 Vss 引脚,则可能引发闩锁现象。

一旦发生闩锁现象, 电源电流急增可能导致元件热损伤。

• 稳定电源电压

务必使电源电压保持稳定。

即便在 Vcc 电源电压的保证工作范围内,电源电压的瞬变也可能引发故障。

电压稳定要以下列两者为基准。在商用频率 (50 Hz/60 Hz) 下的 Vcc 汶波变动 (P-P 值) 要保持在标准 Vcc 的 10%或以下; 在电源切换等短暂变化时,需把电压的瞬变率控制在 0.1 V/ms 或以下。

• 外部时钟的使用注意事项

即便使用外部时钟时,上电复位、从副时钟模式或停止模式唤醒等也需要振荡稳定等待时间。

■ 引脚连接

• 未用引脚的处理

悬空未用输入引脚可能因异常操作或闩锁现象而造成器件永久性损坏。应通过 2 kΩ 及以上的电阻器始终上拉 / 下拉未用输入引脚。将未用输入 / 输出引脚设置为输出状态并悬空,或设置为输入状态并与未用输入引脚同等处理。若存在未用输出引脚,将其悬空。

• 电源引脚

为降低额外的电磁辐射、防止地电平升高引起选通信号故障、确保符合总输出电流标准,在器件外部,需始终将 Vcc 引脚和 Vss 引脚连接到电源并接地。另外,在低阻抗状态下将电流源连接至 Vcc 引脚和 Vss 引脚。推荐在该器件附近的 Vcc 引脚和 Vss 引脚之间,连接一个约 0.1 uF 的陶瓷旁路电容器。

• DBG 引脚

直接将 DBG 引脚连接至外部上拉电阻器。

为防止器件因噪声而意外进入调试模式,设计印刷电路板布局时需将 DBG 引脚和 Vcc 引脚或 Vss 引脚间的 距离最小化。

解除复位输出前,上电后的 DBG 引脚不应保持在 "L" 电平。

• RST 引脚

直接将 RST 引脚连接至外部上拉电阻器。

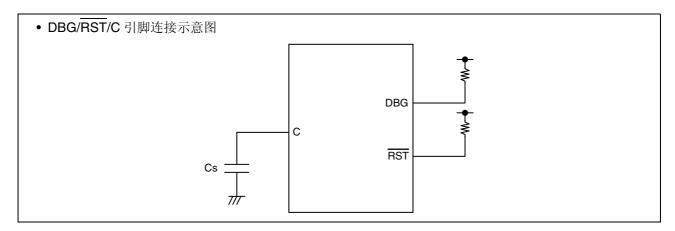
为防止器件因噪声而意外进入复位模式,设计印刷电路板布局时需将 RST 引脚和 Vcc 或 Vss 引脚间的距离最小化。

上电后,RST/PF2 引脚用作复位 I/O 引脚。另外,复位输出可由 SYSC 寄存器的 RSTOE 位使能;复位输入功能和通用 I/O 功能可由 SYSC 寄存器的 RSTEN 位选择。

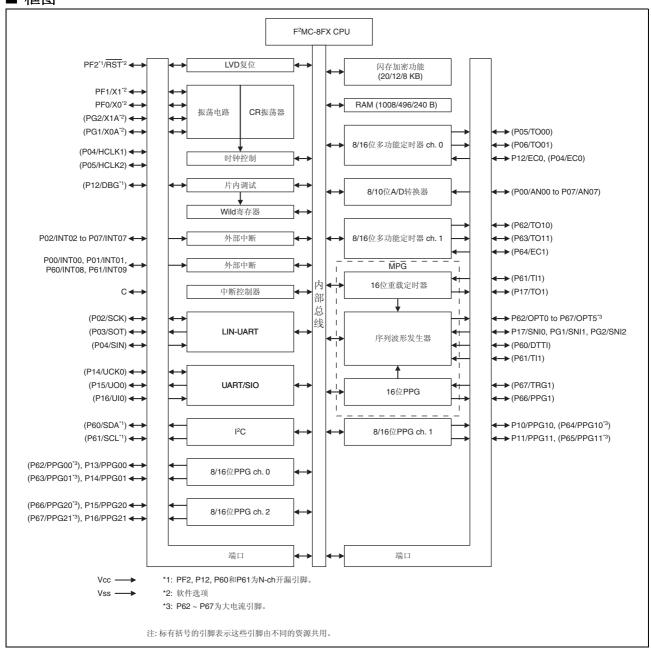
• C 引脚

使用陶瓷电容器或具有等频特性的电容器。Vcc 引脚的旁路电容器必须具有高于 Cs 的电容值。关于平滑电容器 Cs 的详细连接方法,参考下图。

为防止器件因噪声而意外进入未知模式,设计印刷电路板布局时,需将 C 引脚和 Cs 的距离以及 Cs 和 Vss 引脚的距离最小化。



■ 框图



■ CPU 内核

• 存储空间

MB95330H 系列的存储空间为 64 KB,由 I/O 区、数据区和程序区构成。存储空间包含诸如通用寄存器和向量表等专用区。以下是 MB95330H 系列的存储器映射图。

• 存储器映射

	MB95F332H/F332K		MB95F333H/F333K		MB95F334H/F334K
0000н 0080н 0090н 0100н 0180н	I/O 禁止访问 BAM 240 B	0000H 0080H 0090H 0100H 0200H	I/O 禁止访问 RAM 496 B 寄存器	0000H 0080H 0090H 0100H 0200H	I/O 禁止访问 RAM 1008 B 寄存器
0 F 80н	禁止访问	0F80н -	禁止访问	0480н - 0F80н -	禁止访问
1000н	扩展 I/O	1000н	扩展 I/O	1000н -	扩展 I/O
	禁止访问		禁止访问		禁止访问
В000н С000н	闪存 4 KB	В000н - С000н -	闪存4 KB	В000н -	
	禁止访问	Е000н -	禁止访问		闪存 20 KB
F000 _H	闪存 4 KB	FFFFH	闪存8 KB	FFFF _H	

■ I/O 映射

地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
0000н	PDR0	P0 口数据寄存器	R/W	0000000В
0001н	DDR0	P0 口方向寄存器	R/W	0000000В
0002н	PDR1	P1 口数据寄存器	R/W	0000000В
0003н	DDR1	P1 口方向寄存器	R/W	0000000В
0004н		(禁止)	_	_
0005н	WATR	振荡稳定等待时间设置寄存器	R/W	111111111
0006н	_	(禁止)	_	_
0007н	SYCC	系统时钟控制寄存器	R/W	0000Х011в
0008н	STBC	待机控制寄存器	R/W	00000XXX _B
0009н	RSRR	复位源寄存器	R/W	XXXXXXXXB
000Ан	TBTC	时基定时器控制寄存器	R/W	0000000в
000Вн	WPCR	计时预分频器控制寄存器	R/W	0000000в
000Сн	WDTC	监视定时器控制寄存器	R/W	00XX0000B
000Dн	SYCC2	系统时钟控制寄存器 2	R/W	XX100011 _B
000Ен				
~ 0015н	_	(禁止)	_	_
0015н	PDR6	P6 口数据寄存器	R/W	00000000в
0017н	DDR6	P6 口方向寄存器	R/W	0000000В
0017н	DD110	F0 口刀凹可行船	11/ VV	00000008
~	-	(禁止)	_	_
0027н		` '		
0028н	PDRF	PF 口数据寄存器	R/W	0000000в
0029н	DDRF	PF 口方向寄存器	R/W	0000000в
002Ан	PDRG	PG 口数据寄存器	R/W	0000000в
002Вн	DDRG	PG 口方向寄存器	R/W	0000000в
002Сн	PUL0	P0 口上拉寄存器	R/W	0000000в
002Dн	PUL1	P1 口上拉寄存器	R/W	0000000в
002Ен				
~ 0034н	<u>—</u>	(禁止)		_
0035н	PULG	PG 口上拉寄存器	R/W	00000000
0036н	T01CR1	8/16 位多功能定时器 01 状态控制寄存器 1 ch. 0	R/W	0000000В
0037н	T00CR1	8/16 位多功能定时器 00 状态控制寄存器 1 ch. 0	R/W	0000000
0038н	T11CR1	8/16 位多功能定时器 11 状态控制寄存器 1 ch. 1	R/W	0000000
0039н	T10CR1	8/16 位多功能定时器 10 状态控制寄存器 1 ch. 1	R/W	0000000
003Ан	PC01	8/16 位 PPG 定时器 01 控制寄存器	R/W	0000000В
003Вн	PC00	8/16 位 PPG 定时器 00 控制寄存器	R/W	0000000
003Сн	PC11	8/16 位 PPG 定时器 11 控制寄存器	R/W	0000000
003Dн	PC10	8/16 位 PPG 定时器 10 控制寄存器	R/W	0000000
003Ен	PC21	8/16 位 PPG 定时器 21 控制寄存器	R/W	0000000
003Fн	PC20	8/16 位 PPG 定时器 20 控制寄存器	R/W	0000000



地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
0040н	TMCSRH1	16 位重载定时器控制状态寄存器高位 ch. 1	R/W	0000000В
0041н	TMCSRL1	16 位重载定时器控制状态寄存器低位 ch. 1	R/W	0000000В
0042н, 0043н	_	(禁止)	_	_
0044н	PCNTH1	16 位 PPG 状态控制寄存器高位 ch. 1	R/W	0000000В
0045н	PCNTL1	16 位 PPG 状态控制寄存器低位 ch. 1	R/W	0000000В
0046н, 0047н	_	(禁止)	_	_
0048н	EIC00	外部中断电路控制寄存器 ch. 0/ch. 1	R/W	0000000В
0049н	EIC10	外部中断电路控制寄存器 ch. 2/ch. 3	R/W	0000000В
004Ан	EIC20	外部中断电路控制寄存器 ch. 4/ch. 5	R/W	0000000В
004Вн	EIC30	外部中断电路控制寄存器 ch. 6/ch. 7	R/W	0000000В
004Сн	EIC01	外部中断电路控制寄存器 ch. 8/ch. 9	R/W	0000000В
004Dн ~	_	(禁止)	_	_
004Fн		(
0050н	SCR	LIN-UART 串行控制寄存器	R/W	0000000В
0051н	SMR	LIN-UART 串行模式寄存器	R/W	0000000В
0052н	SSR	LIN-UART 串行状态寄存器	R/W	00001000в
0053н	RDR/TDR	LIN-UART 接收 / 发送数据寄存器	R/W	0000000В
0054н	ESCR	LIN-UART 扩展状态控制寄存器	R/W	00000100в
0055н	ECCR	LIN-UART 扩展通信控制寄存器	R/W	000000XXB
0056н	SMC10	UART/SIO 串行模式控制寄存器 1 ch. 0	R/W	0000000В
0057н	SMC20	UART/SIO 串行模式控制寄存器 2 ch. 0	R/W	00100000в
0058н	SSR0	UART/SIO 串行状态和数据寄存器 ch. 0	R/W	0000001в
0059н	TDR0	UART/SIO 串行输出数据寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
005Ан	RDR0	UART/SIO 串行输入数据寄存器 ch. 0	R	0000000В
005Вн ~	_	(禁止)	_	_
005Fн	IDODAA		D 244	
0060н	IBCR00	I ² C 总线控制寄存器 0	R/W	0000000В
0061н	IBCR10	I ² C 总线控制寄存器 1	R/W	0000000в
0062н	IBSR0	I ² C 总线状态寄存器	R/W	0000000в
0063н	IDDR0	I ² C 数据寄存器	R/W	0000000В
0064н	IAAR0	I ² C 地址寄存器	R/W	0000000в
0065н	ICCR0	I ² C 时钟控制寄存器	R/W	0000000В
0066н	OPCUR	16 位 MPG 输出控制寄存器 (高位)	R/W	0000000В
0067н	OPCLR	16 位 MPG 输出控制寄存器 (低位)	R/W	0000000В
0068н	IPCUR	16 位 MPG 输入控制寄存器 (高位)	R/W	0000000В
0069н	IPCLR	16 位 MPG 输入控制寄存器 (低位)	R/W	0000000В

(转下页)

21



地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
006Ан	NCCR	16 位 MPG 噪声忽略控制寄存器	R/W	00000000в
006Вн	TCSR	16 位 MPG 定时器控制状态寄存器	R/W	00000000в
006Сн	ADC1	8/10 位 A/D 转换器控制寄存器 1	R/W	00000000в
006Dн	ADC2	8/10 位 A/D 转换器控制寄存器 2	R/W	0000000
006Ен	ADDH	8/10 位 A/D 转换器数据寄存器 (高位)	R/W	0000000В
006Fн	ADDL	8/10 位 A/D 转换器数据寄存器 (低位)	R/W	0000000В
0070н	1	(禁止)		
0071н	FSR2	闪存状态寄存器 2	R/W	0000000В
0072н	FSR	闪存状态寄存器	R/W	000Х0000в
0073н	SWRE0	闪存扇区编程使能控制寄存器 0	R/W	0000000В
0074н	FSR3	闪存状态寄存器 3	R	0000XXXXB
0075н	_	(禁止)	_	
0076н	WREN	Wild 寄存器地址比较使能寄存器	R/W	0000000В
0077н	WROR	Wild 寄存器数据测试设置寄存器	R/W	0000000В
0078н	_	寄存器组指针 (RP) 和直接组指针 (DP) 的镜像地址	_	
0079н	ILR0	中断级设置寄存器 0	R/W	111111111в
007Ан	ILR1	中断级设置寄存器 1	R/W	11111111В
007Вн	ILR2	中断级设置寄存器 2	R/W	11111111В
007Сн	ILR3	中断级设置寄存器 3	R/W	11111111В
007Dн	ILR4	中断级设置寄存器 4	R/W	111111111
007Ен	ILR5	中断级设置寄存器 5	R/W	111111111
007Fн		(禁止)	_	
0F80н	WRARH0	Wild 寄存器地址设置寄存器 (高位) ch. 0	R/W	0000000В
0F81н	WRARL0	Wild 寄存器地址设置寄存器 (低位) ch. 0	R/W	0000000В
0F82н	WRDR0	Wild 寄存器数据设置寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
0F83н	WRARH1	Wild 寄存器地址设置寄存器 (高位) ch. 1	R/W	0000000В
0F84н	WRARL1	Wild 寄存器地址设置寄存器 (低位) ch. 1	R/W	0000000В
0F85н	WRDR1	Wild 寄存器数据设置寄存器 ch. 1	R/W	0000000В
0F86н	WRARH2	Wild 寄存器地址设置寄存器 (高位) ch. 2	R/W	0000000В
0F87н	WRARL2	Wild 寄存器地址设置寄存器 (低位) ch. 2	R/W	0000000В
0F88н	WRDR2	Wild 寄存器数据设置寄存器 ch. 2	R/W	0000000В
0F89н				
~ 0F91н	-	(禁止)	_	_

地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
0F92н	T01CR0	8/16 位多功能定时器 01 状态控制寄存器 0 ch. 0	R/W	0000000В
0F93н	T00CR0	8/16 位多功能定时器 00 状态控制寄存器 0 ch. 0	R/W	0000000в
0F94н	T01DR	8/16 位多功能定时器 01 数据寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
0F95н	T00DR	8/16 位多功能定时器 00 数据寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
0F96н	TMCR0	8/16 位多功能定时器 00/01 定时器模式控制寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
0F97н	T11CR0	8/16 位多功能定时器 11 状态控制寄存器 0 ch. 1	R/W	0000000В
0F98н	T10CR0	8/16 位多功能定时器 10 状态控制寄存器 0 ch. 1	R/W	0000000В
0F99н	T11DR	8/16 位多功能定时器 11 数据寄存器 ch. 1	R/W	0000000В
0F9Ан	T10DR	8/16 位多功能定时器 10 数据寄存器 ch. 1	R/W	0000000В
0F9Вн	TMCR1	8/16 位多功能定时器 10/11 定时器模式控制寄存器 ch. 1	R/W	0000000В
0F9Cн	PPS01	8/16 位 PPG01 周期设置缓冲器寄存器 ch. 0	R/W	11111111в
0F9Dн	PPS00	8/16 位 PPG00 周期设置缓冲器寄存器 ch. 0	R/W	11111111В
0F9Ен	PDS01	8/16 位 PPG01 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 0	R/W	11111111В
0F9Fн	PDS00	8/16 位 PPG00 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 0	R/W	11111111В
0FА0н	PPS11	8/16 位 PPG11 周期设置缓冲器寄存器 ch. 1	R/W	11111111В
0FA1н	PPS10	8/16 位 PPG10 周期设置缓冲器寄存器 ch. 1	R/W	11111111В
0FA2н	PDS11	8/16 位 PPG11 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 1	R/W	11111111В
0FАЗн	PDS10	8/16 位 PPG10 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 1	R/W	11111111В
0FA4н	PPGS	8/16 位 PPG 启动寄存器	R/W	0000000В
0FА5н	REVC	8/16 位 PPG 输出取反寄存器	R/W	0000000В
0FA6н	PPS21	8/16 位 PPG21 周期设置缓冲器寄存器 ch. 2	R/W	11111111В
0FA7н	PPS20	8/16 位 PPG20 周期设置缓冲器寄存器 ch. 2	R/W	11111111В
0FA8н	TMRH1	16 位定时器寄存器 (高位) ch. 1	R/W	0000000в
OI AGH	TMRLRH1	16 位重载寄存器 (高位) ch. 1	11/ / /	ОООООООВ
0FА9н	TMRL1	16 位定时器寄存器 (低位) ch. 1	R/W	00000000в
017(011	TMRLRL1	16 位重载寄存器 (低位) ch. 1	11/ * *	00000000
0ГААн	PDS21	8/16 位 PPG21 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 2	R/W	111111111
0FABн	PDS20	8/16 位 PPG20 占空比设置缓冲器寄存器 ch. 2	R/W	111111111
0FACн				
~ 0FAFн	_	(禁止)	_	_
0FB0н	PDCRH1	16 位 PPG 递减计数器寄存器 (高位) ch. 1	R	00000000в
0FВ1н	PDCRL1	16 位 PPG 递减计数器寄存器 (低位) ch. 1	R	00000000В
0FB2н	PCSRH1	16 位 PPG 周期设置缓冲器寄存器(高位)ch. 1	R/W	111111111
0FB3н	PCSRL1	16 位 PPG 周期设置缓冲器寄存器(低位)ch. 1	R/W	111111111
0FВ4н	PDUTH1	16 位 PPG 占空比设置缓冲器寄存器(高位)ch. 1	R/W	11111111 _B
0FB5н	PDUTL1	16 位 PPG 占空比设置缓冲器寄存器(低位)ch. 1	R/W	111111111B
01 00	, DOILI	_ 10 应 1 1 0 日 工	1 1/ V V	11111111

地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
0FB6н				
~ 0FBBн	_	(禁止)	_	_
0FBC _H	BGR1	LINI LIADT 油桩家华什盟安方思 1	R/W	0000000в
0FBDн	BGR0	LIN-UART 波特率发生器寄存器 1	R/W	00000000в
0FBE _H	PSSR0	LIN-UART 波特率发生器寄存器 0	R/W	0000000В
0FBF _H	BRSR0	UART/SIO 预分频器选择寄存器 ch. 0	R/W	0000000В
0FC0н	BNSNU	UART/SIO 波特率设置寄存器 ch. 0	I T/ V V	0000000В
~	_	(禁止)	_	_
0FC2н		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
0FС3н	AIDRL	A/D 输入禁止寄存器 (低位)	R/W	0000000В
0FС4н	OPDBRH0	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 0	R/W	0000000В
0FC5н	OPDBRL0	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 0	R/W	0000000В
0FС6н	OPDBRH1	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 1	R/W	0000000В
0FС7н	OPDBRL1	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 1	R/W	0000000В
0FC8н	OPDBRH2	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 2	R/W	0000000В
0FС9н	OPDBRL2	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 2	R/W	0000000в
0FСАн	OPDBRH3	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 3	R/W	0000000в
0FСВн	OPDBRL3	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 3	R/W	0000000в
0ГССн	OPDBRH4	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 4	R/W	0000000в
0FCD _H	OPDBRL4	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 4	R/W	0000000в
0ГСЕн	OPDBRH5	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 5	R/W	0000000в
0FCFн	OPDBRL5	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 5	R/W	0000000в
0FD0н	OPDBRH6	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 6	R/W	0000000в
0FD1н	OPDBRL6	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 6	R/W	0000000в
0FD2н	OPDBRH7	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 7	R/W	0000000в
0FD3н	OPDBRL7	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 7	R/W	0000000в
0FD4н	OPDBRH8	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 8	R/W	0000000в
0FD5н	OPDBRL8	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 8	R/W	0000000в
0FD6н	OPDBRH9	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. 9	R/W	0000000в
0FD7н	OPDBRL9	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. 9	R/W	0000000в
0FD8н	OPDBRHA	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. A	R/W	0000000в
0FD9н	OPDBRLA	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. A	R/W	0000000в
0FDA _н	OPDBRHB	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (高位) ch. B	R/W	0000000В
0FDBн	OPDBRLB	16 位 MPG 输出数据缓冲器寄存器 (低位) ch. B	R/W	0000000В
0FDC _н	OPDUR	16 位 MPG 输出数据寄存器 (高位)	R	0000XXXXB
0FDD _H	OPDLR	16 位 MPG 输出数据寄存器 (低位)	R	XXXXXXXX
0FDE _H	CPCHR	16 位 MPG 比较清零寄存器 (高位)	R/W	XXXXXXXX
0FDF _н	CPCLR	16 位 MPG 比较清零寄存器 (低位)	R/W	XXXXXXXX
0FE0н,	_			_
0FE1н		(禁止)		



(承上页)

地址	寄存器缩写	寄存器名称	R/W	初始值
0FE2н	TMBUR	16 位 MPG 定时器缓冲器存器 (高位)	R	XXXXXXX
0FE3н	TMBLR	16 位 MPG 定时器缓冲器寄存器 (低位)	R	XXXXXXX
0FE4н	CRTH	主 CR 时钟调节寄存器 (高位)	R/W	0XXXXXXXB
0FE5н	CRTL	主 CR 时钟调节寄存器 (低位)	R/W	00XXXXXXB
0FE6н, 0FE7н	_	(禁止)		_
0FE8н	SYSC	系统配置寄存器	R/W	11000011в
0FE9н	CMCR	时钟监控控制寄存器	R/W	0000000в
0FEAн	CMDR	时钟监控数据寄存器	R	0000000в
0FEBн	WDTH	监视定时器选择 ID 寄存器 (高位)	R	XXXXXXX
0FECн	WDTL	监视定时器选择 ID 寄存器 (低位)	R	XXXXXXX
0FEDн	_	(禁止)		_
0FEE _H	ILSR	输入电平选择寄存器	R/W	0000000в
0FEFн	WICR	输入引脚控制寄存器	R/W	01000000в
OFEOH ~ OFFFH	_	(禁止)	_	_

• R/W 访问符号

R/W :读/写 R : 只读 W :只写

• 初始值符号

0 :该位的初始值为 "0"。1 :该位的初始值为 "1"。X :该位的初始值为不定值。

注:切勿向"(禁止)"地址写值。读取"(禁止)"地址时,返回不确定的值。

■ 中断源一览表

		ーー 向量ネ	 長地址	ᆂᄣᇭᇄᄪᆄ	同级中断源
中断源	中断请求号	断请求号 高位 地位		中断级设置寄存器的位名称	的优先顺序 (同时发生时)
外部中断 ch. 0, ch. 4	IRQ00	FFFA⊦	FFFB⊦	L00 [1:0]	高
外部中断 ch. 1, ch. 5	IRQ01	FFF8⊦	FFF9 _H	L01 [1:0]	A
外部中断 ch. 2, ch. 6	IRQ02	FFF6⊦	FFF7 _H	L02 [1:0]	
外部中断 ch. 3, ch. 7	IRQ03	FFF4 _H	FFF5 _H	L03 [1:0]	
UART/SIO ch. 0, MPG (DTTI)	IRQ04	FFF2 _H	FFF3 _H	L04 [1:0]	
8/16 位多功能定时器 ch. 0 (低位)	IRQ05	FFF0 _H	FFF1 _H	L05 [1:0]	
8/16 位多功能定时器 ch. 0 (高位)	IRQ06	FFEEH	FFEFH	L06 [1:0]	
LIN-UART (接收)	IRQ07	FFECH	FFED⊦	L07 [1:0]	
LIN-UART (发送)	IRQ08	FFEA	FFEB⊦	L08 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 1 (低位)	IRQ09	FFE8 _H	FFE9 _H	L09 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 1 (高位)	IRQ10	FFE6⊦	FFE7 _H	L10 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 2(高位)	IRQ11	FFE4 _H	FFE5 _H	L11 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 0 (高位)	IRQ12	FFE2 _H	FFE3 _H	L12 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 0 (低位)	IRQ13	FFE0⊦	FFE1 _H	L13 [1:0]	
8/16 位多功能定时器 ch. 1 (高位)	IRQ14	FFDE _H	FFDF⊦	L14 [1:0]	
8/16 位 PPG ch. 2 (低位)	IRQ15	FFDC _H	FFDD⊦	L15 [1:0]	
16 位重载定时器 1, MPG (写入顺序/比较清零), I ² C	IRQ16	FFDA _H	FFDB⊦	L16 [1:0]	
16 位 PPG ch. 1, MPG (位置检测 / 比较匹配)	IRQ17	FFD8 _H	FFD9 _H	L17 [1:0]	
8/10 位 A/D 转换器	IRQ18	FFD6⊦	FFD7 _H	L18 [1:0]	
时基定时器	IRQ19	FFD4 _H	FFD5 _H	L19 [1:0]	
计时预分频器	IRQ20	FFD2 _H	FFD3 _H	L20 [1:0]	
外部中断 ch. 8, ch. 9	IRQ21	FFD0 _H	FFD1 _H	L21 [1:0]	
8/16 位多功能定时器 ch. 1 (低位)	IRQ22	FFCEH	FFCF _H	L22 [1:0]	\
闪存	IRQ23	FFCCH	FFCDн	L23 [1:0]	低

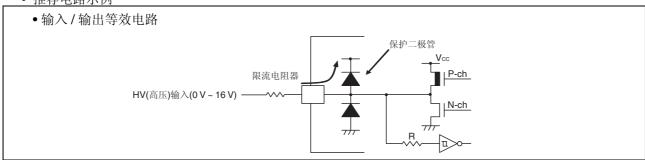
■ 电气特性

1. 绝对最大额定值

会 樂	<i>/</i> // □.	额是	定值	 - 单位	备 注	
参数	符号	最小	最大	一甲 似	企業	
电源电压 *1	Vcc	Vss - 0.3	Vss + 6	V		
输入电压 *1	Vı	Vss - 0.3	Vss + 6	V	*2	
输出电压 *1	Vo	Vss - 0.3	Vss + 6	V	*2	
最大钳位电流	CLAMP	-2	+2	mA	适用于指定引脚*3	
合计最大钳位电流	$\Sigma I_{CLAMP} $	_	20	mA	适用于指定引脚*3	
	lo _{L1}		15	- mA	P62 ~ P67 除外	
"L" 电平最大输出电流	lol2	_	15] ""A	P62 ~ P67	
叫『中亚亚わ中次	lolav1	_	4	mA	P62~P67除外的平均输出电流 = 工作电流 × 运行比例 (1 条引脚)	
"L" 电平平均电流	lolav2	_	12		P62~P67的平均输出电流=工作电流×运行比例(1条引脚)	
"L" 电平合计最大输出电流	ΣΙοι	_	100	mA		
"L" 电平合计平均输出电流	Σ lolav	_	50	mA	合计平均输出电流 = 工作电流 × 运 行比例 (引脚总数)	
	І он1	_	-15	A	P62 ~ P67 除外	
"H" 电平最大输出电流	І он2	_	-15	- mA	P62 ~ P67	
IIII 中亚亚拉中沙	lohav1	_	-4	mA	P62~P67除外的平均输出电流 = 工作电流 × 运行比例 (1 条引脚)	
"H" 电平平均电流	lohav2	_	-8		P62~P67的平均输出电流=工作电流×运行比例(1条引脚)	
"H" 电平合计最大输出电流	ΣІон	_	-100	mA		
"H" 电平合计输出电流	Σ lohav	_	-50	mA	合计平均输出电流 = 工作电流 × 运 行比例 (引脚总数)	
功耗	Pd	_	320	mW		
工作温度	TA	-40	+85	°C		
保存温度	Tstg	-55	+150	°C		

(承上页)

- *1: 该参数基于 Vss = 0.0 V.
- *2: V_I 和 V_O 不可超出 V_{CC} + 0.3 V_O V_I 不可超出额定电压值。如果使用外部元件限制至 / 自输入引脚的最大电流,则不使用 V_I 额定值而是使用 I_{CLAMP} 额定值。
- *3: 使用引脚: P00~P07, P10, P11, P13~P17, P62~P67, PF0, PF1, PG1和PG2
 - 在推荐工作条件下使用。
 - DC 电压(电流)时使用。
 - HV(高压)信号是超出 Vcc 电压的输入信号。使用 HV(高压)信号前,必须在 HV(高压)信号和微控制器 之间连接限流电阻器。
 - 限流电阻器的设定值符合以下条件:无论在瞬变电流还是恒定电流条件下,输入 HV(高压)信号时,该值保证输入到微控制器引脚的电流低于标准值。
 - 微控制器驱动电流低下时,例如在低功耗模式下,HV(高压)输入电位可能穿过保护二极管以增大 Vcc 引脚的电位,从而影响其他器件。
 - 如果在微控制器电源关闭 (不固定在 0 V) 时输入 HV(高压)信号,因为电源从引脚提供,所以会发生不完全运行。
 - 如果上电后输入 HV(高压) 信号,因为电源从引脚提供,电源电压可能不足以使能上电复位。
 - 不可悬空 HV(高压) 输入引脚。
 - 推荐电路示例



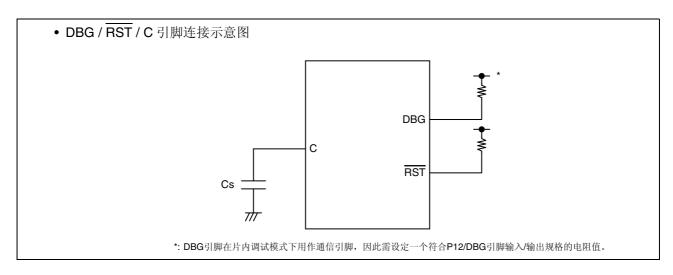
警告:在半导体器件上施加重荷(电压、电流、温度等超出最大额定值)可能引起器件永久性损坏。因此需注意任何参数不得超出其绝对最大额定值。

2. 推荐工作条件

(Vss = 0.0 V)

⇔ ₩	符号	额兒	定值	单位	/s	, y ,	
参数	多数 175 最小 最大 中位		1	备注			
		2.4*1*2	5.5*1		正常工作时	L 中部子株子 N 和	
中海中 [5]	Vcc	2.3	5.5	V	停止模式下的保持状态	片内调试模式以外	
电源电压	VCC	2.9	5.5	ľ	正常工作时	L 占 油 2 # 4	
		2.3	5.5		停止模式下的保持状态	- 片内调试模式	
平滑电容器	Cs	0.022	1	μF	*3		
/L/II Pc		-40	+85	°C	片内调试模式以外		
工作温度	TA	+5	+35		片内调试模式		

- *1: 该值因工作频率、机器时钟或模拟保证范围而异。
- *2: 使用低压检测复位功能时,该值为 2.88 V。
- *3: 使用陶瓷电容器或带等频特性的电容器。 Vcc 引脚的旁路电容器的电容值必须大于 Cs。关于平滑电容器 Cs的连接,参考下图。为防止器件因噪声而意外进入未知模式,设计印刷电路板的平面图时,使 C 引脚和 Cs、Cs 和 Vss 引脚的间距最小化。



警告:为了保证半导体器件的正常工作,需确保推荐工作条件。器件在推荐工作条件范围内运行时,全部电气 特性均可得到保证。

务必在推荐工作条件范围内使用半导体器件。超出工作范围的使用可能会影响半导体的可靠性并导致器件故障。

对于本数据手册中未记载的用途、工作条件或二者兼而有之,不做任何保障。如果用户考虑在所列条件之外使用器件,请事先联系销售代表。

3. DC 特性

(Vcc = 5.0 V±10%, Vss = 0.0 V, Ta = -40 $^{\circ}\mathrm{C}$ ~ +85 $^{\circ}\mathrm{C}$)

63 W.	₩ □	71 Nur 6-76	Ar Iti.		额定值	<u> </u>	24.24	A7 34-	
参数	符号	引脚名称	条件	最小	典型	最大	单位	备注	
	Vihi	P04, P16, P60, P61	*1	0.7 Vcc	ı	Vcc + 0.3	V	选择 CMOS 输入 电平(迟滞输入) 时	
"H" 电平输 入电压	Vihs	P00 ~ P07, P10 ~ P17, P60 ~ P67, PF0, PF1, PG1, PG2	*1	0.8 Vcc	-	Vcc + 0.3	V	迟滞输入	
	VIHM	PF2	_	0.7 Vcc	_	Vcc + 0.3	V	迟滞输入	
	VıL	P04, P16, P60, P61	*1	Vss - 0.3	_	0.3 Vcc	V	选择 CMOS 输入 电平(迟滞输入) 时	
"L" 电平输入 电压	P00 ~ P07, P10 ~ P17, VLS P60 ~ P67, PF0, PF1, PG1, PG2		*1	Vss - 0.3	_	0.2 Vcc	V	迟滞输入	
	VILM	PF2	_	Vss - 0.3	_	0.3 Vcc	V	迟滞输入	
开漏输出应 用电压	VD	P12, P60, P61, PF2	_	Vss - 0.3	_	V _{ss} + 5.5	٧		
"H" 电平输	V _{OH1}	P60 ~ P67 除 外的输出引脚	Iон = −4 mA	Vcc - 0.5	_	_	٧		
出电压	V_{OH2}	P62 ~ P67	Iон = −8 mA	Vcc - 0.5		_	V		
 "L" 电平输出	V _{OL1}	P60 ~ P67 除 外的输出引脚	loL = 4 mA	_	_	0.4	V		
电压	V_{OL2}	P62 ~ P67	loL = 12 mA	_		0.4	V		
输入泄漏电流 (Hi-Z 输出泄漏电流)	lu	全部输入引脚	0.0 V < Vı < Vcc	-5	ı	+5	μΑ	禁止上拉电阻时	
上拉电阻	Rpull	P00 ~ P07, P10, P11, P13 ~ P17, PG1, PG2	V1 = 0 V	25	50	100	kΩ	使能上拉电阻时	
输入电容	Cin	Vcc 和 Vss 除外	f = 1 MHz	_	5	15	pF		

(Vcc = 5.0 V±10%, Vss = 0.0 V, Ta = -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C)

会业	<i>h</i> h 🗆	그! Pin <i>5 15</i> -	友体		额定值		* 1	A7 334-
参数	符号	引脚名称	条 件	最小	典型	最大	单位	备注
			Vcc = 5.5 V Fch = 32 MHz	_	13	17	mA	闪存产品 (写/擦除外)
	Icc		F _{MP} = 16 MHz 主时钟模式	_	20.5	26.5	mA	闪存产品 (写/擦)
			(2 分频)	_	15	21	mA	A/D 转换时
	Iccs		Vcc = 5.5 V Fch = 32 MHz Fmp = 16 MHz 主休眠模式 (2 分频)	_	5.5	9	mA	
	Iccl	V cc (外部时钟工作)	Vcc = 5.5 V FcL = 32 kHz FMPL = 16 kHz 副时钟模式 (2 分频) T _A = +25 ℃	_	65	153	μΑ	
电源电流 *2	IccLs		Vcc = 5.5 V FcL = 32 kHz FMPL = 16 kHz 副休眠模式 (2 分频) T _A = +25 ℃	_	10	84	μΑ	
	Ісст		Vcc = 5.5 V FcL = 32 kHz 计时模式 主停止模式 Ta = +25 ℃	_	5	30	μΑ	
	Іссмся	Vcc	Vcc = 5.5 V FcrH = 12.5 MHz FMP = 12.5 MHz 主 CR 时钟模式	_	10	13.2	mA	
	Iccscr	•	Vcc = 5.5 V 副 CR 时钟模式 (2 分频) T _A = +25 ℃	_	110	410	μΑ	

(承上页)

 $(V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 10\%, \text{ V}_{SS} = 0.0 \text{ V}, \text{ T}_{A} = -40 ^{\circ}\text{C} ^{\sim} +85 ^{\circ}\text{C})$

会业	<i>h</i> h 口	그! 마!! <i>는 1등</i>	A 14		额定值		* 12	全
参数	符号	引脚名称	条件	最小		最大	单位	甘 仁
	Ісстѕ	V cc (外部时钟工作)	Vcc = 5.5 V Fcн = 32 MHz 时基定时器模式 Ta = +25 ℃		1.1	3	mA	
4. VE 4. VE 40	Іссн	(21,464,144,77.11-)	Vcc = 5.5 V 副停止模式 T _A = +25 ℃		3.5	22.5	μΑ	
电源电流 *2	I LVD		仅低压检测电路的 功耗		37	54	μΑ	
	Ісян	Vcc	主 CR 振荡器的功 耗	_	0.5	0.6	mA	
	Icrl		副 CR 振荡器以 100 kHz 振荡时的 功耗	_	20	72	μΑ	

^{*1:}使用输入电平选择寄存器 (ILSR) 可将 P04, P16, P60 和 P61 的输入电平切换为 "CMOS 输入电平 " 或 " 迟滞 输入电平 "。

- *2: 电源电流取决于外部时钟。选择低压检测选项时,电源电流为低压检测电流 (luvo) 的功耗与 lcc ~ lccн 其中一值之和。另外,选择低压检测选项和 CR 振荡器两者时,电源电流为低压检测电流的功耗、 CR 振荡器 (lcrh, lcrl) 及指定值三者之和。片内调试模式下,始终使能 CR 振荡器 (lcrh) 和低压检测电路,因此功耗随之增大。
 - 关于 Fcн 和 FcL,参考 "4. AC 特性: (1) 时钟时序 "。
 - 关于 FMP 和 FMPL,参考 "4. AC 特性: (2)源时钟/机器时钟"。

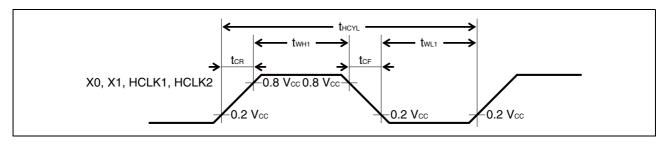
4. AC 特性

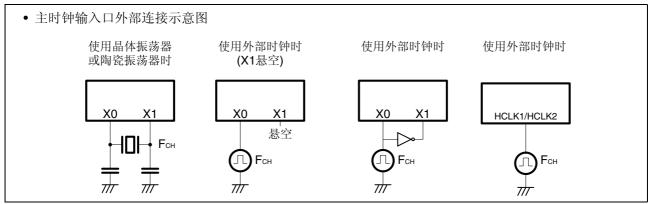
(1) 时钟时序

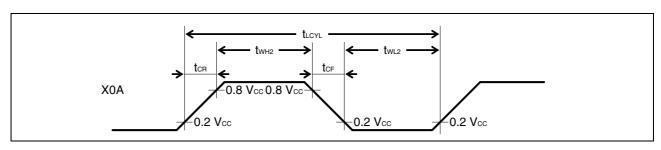
(Vcc = 2.4 V \sim 5.5 V, Vss = 0.0 V, TA = -40 $^{\circ}$ C \sim +85 $^{\circ}$ C)

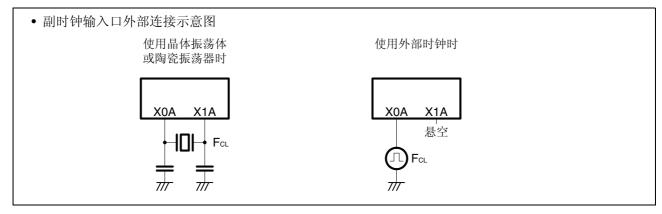
					额定值	0.0 1, 1		,	
参数	符号	引脚名称	条件	最小	典型	最大	单位	备注	
		X0, X1	_	1		16.25	MHz	使用主振荡电路时	
		X0	X1: 悬空	1	_	12	MHz		
	Fсн	X0, X1	*	1		32.5	MHz	使用外部主时钟时	
		HCLK1, HCLK2	_	1		32.5	MHz	(使用外面土町 种町	
				12.25	12.5	12.75	MHz		
				9.8	10	10.2	MHz	使用主 CR 时钟时	
		_	_	7.84	8	8.16	MHz	$T_A = -10^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	
时钟频率	Fcrh			0.98	1	1.02	MHz		
	FCRH		_	12.1875	12.5	12.8125	MHz		
				9.75	10	10.25	MHz	使用主 CR 时钟时	
		_		7.8	8	8.2	MHz	$T_A = -40^{\circ}C \sim -10^{\circ}C$	
				0.975	1	1.025	MHz		
	FcL	X0A, X1A		_	32.768	_	kHz	使用副振荡电路时	
		70A, 71A	_	_	32.768	_	kHz	使用外部副时钟时	
	FCRL	_	_	50	100	200	kHz	使用副 CR 时钟时	
		X0, X1	_	61.5	_	1000	ns	使用主振荡电路时	
		X0	X1: 悬空	83.4	_	1000	ns		
时钟周期时间	thcyL	X0, X1	*	30.8	_	1000	ns	使用外部时钟时	
HJ V[7HJ 799]HJ [HJ		HCLK1, HCLK2		30.8		1000	ns	- 使用外部的钾的	
	tLCYL	X0A, X1A	_		30.5	_	μs	使用副时钟时	
		X0	X1: 悬空	33.4	1	_	ns		
	twH1	X0, X1	*	12.4		_	ns		
输入时钟脉宽	tw∟1	HCLK1, HCLK2	_	12.4	1		ns	使用外部时钟时,占空比应保持在 40% ~ 60%。	
	twH2	X0A	_	_	15.2	_	μs		
输入时钟上升 时间和下降时 间		X0	X1: 悬空	_	_	5	ns		
	tcr	X0, X1	*	_	_	5	ns	使用外部时钟时	
	t cf	HCLK1, HCLK2	_	_	_	5	ns	(文/17/17 19 17 17 17 17 17 17	
CR 振荡启动	tcrhwk	_	_	_	_	80	μs	使用主 CR 时钟时	
时间	tcrlwk	_	_	_	_	10	μs	使用副 CR 时钟时	

^{*:} 外部时钟信号输入到 X0, 取反的外部时钟信号输入到 X1。









(2) 源时钟/机器时钟

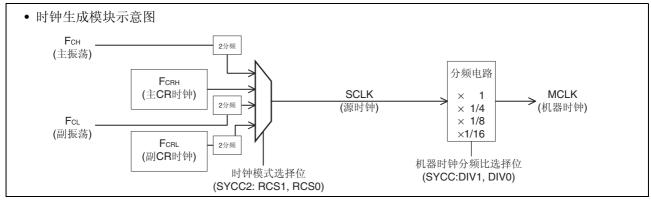
(Vcc = 5.0 V±10%, Vss = 0.0 V, Ta = -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C)

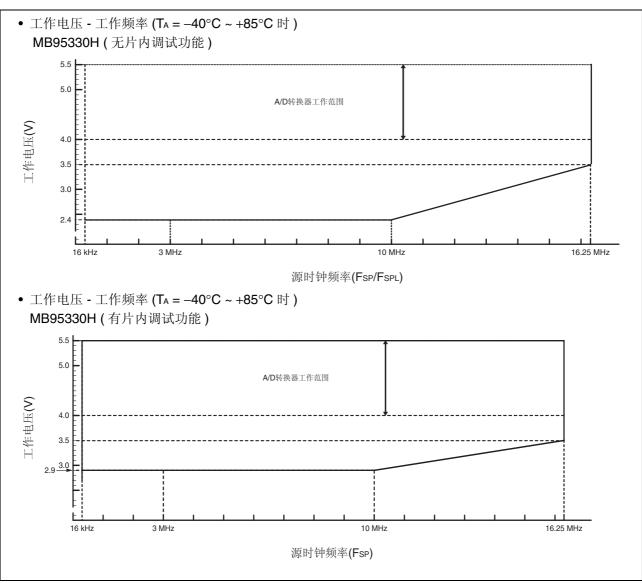
参数	符号	引脚		额定值		单位	备注
多数	11) 5	名称	最小	典型	最大	平位	併 在
			61.5	_	2000	ns	使用外部主时钟时 最小值: FcH = 32.5 MHz, 2 分频 最大值: FcH = 1 MHz, 2 分频
源时钟周期时 间 *1	tsclk	_	80	_	1000	ns	使用主 CR 时钟时 最小值 : Fcrн = 12.5 MHz 最大值 : Fcrн = 1 MHz
			_	61	_	μs	使用副振荡时钟时 FcL = 32 .768 kHz, 2 分频
			_	20	_	μs	使用副 CR 时钟时 FcRL = 100 kHz, 2 分频
	Fsp		0.5	_	16.25	MHz	使用主振荡时钟时
	1 5		1	_	12.5	MHz	使用主 CR 时钟时
源时钟频率		_	_	16.384	_	kHz	使用副振荡时钟时
	F _{SPL}		_	50	_	kHz	使用副 CR 时钟时 FcRL = 100 kHz, 2 分频
			61.5	_	32000	ns	使用主振荡时钟时 最小值: Fsp = 16.25 MHz, 无分频 最大值: Fsp = 0.5 MHz, 16 分频
机器时钟周期 时间 *2	t mclk	_	80		16000	ns	使用主 CR 时钟时 最小值: Fsp = 12.5 MHz 最大值: Fsp = 1 MHz, 16 分频
(最短指令执行时间)	IMOLK		61	_	976.5	μs	使用副振荡时钟时 最小值: Fspl = 16.384 kHz, 无分频 最大值: Fspl = 16.384 kHz, 16 分频
			20	_	320	μs	使用副 CR 时钟时 最小值: Fspl = 50 kHz, 无分频 最大值:Fspl = 50 kHz, 16 分频
	Fмp		0.031	_	16.25	MHz	使用主振荡时钟时
	i Wir		0.0625	_	12.5	MHz	使用主 CR 时钟时
机器时钟频率		_	1.024	_	16.384	kHz	使用副振荡时钟时
	FMPL		3.125	_	50	kHz	使用副 CR 时钟时 FcRL = 100 kHz

^{*1:} 这是由机器时钟分频比选择位 (SYCC:DIV1 和 DIV0) 设定的分频比进行分频前的时钟。该源时钟由机器时钟分频比选择位 (SYCC:DIV1 和 DIV0) 设定的分频比进行分频后成为机器时钟。另外,可从下面选择源时钟:

- 2 分频主时钟
- 主 CR 时钟
- 2 分频副时钟
- 2 分频副 CR 时钟
- *2: 这是微控制器的工作时钟。可从下面选择机器时钟:
 - •源时钟(无分频)
 - 4 分频源时钟
 - 8 分频源时钟
 - 16 分频源时钟

36



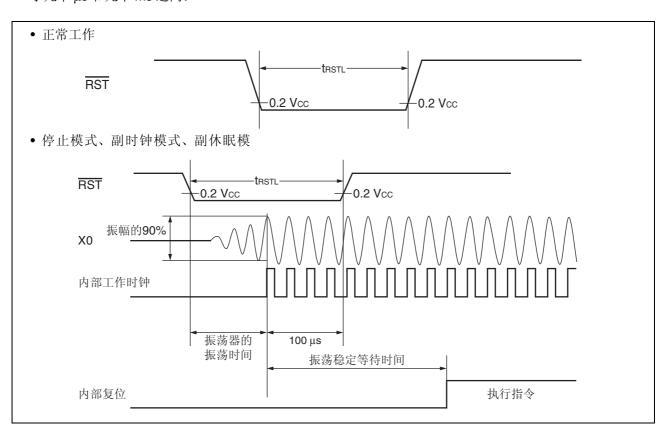


(3) 外部复位

 $(Vcc = 5.0 V \pm 10\%, Vss = 0.0 V, T_A = -40 \% \sim +85 \%)$

参数	符号	额定值		* *	夕 X }
少 数	打石	最小	最大	中位 备注 ns 正常工作	
		2 tmcLK*1	1	ns	正常工作
RST "L" 电平 脉宽	t RSTL	振荡器的振荡时间 *2 + 100	_	μs	停止模式、副时钟模式、副休眠 模式、计时模式以及上电时
		100		μs	时基定时器模式

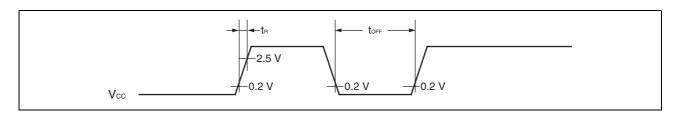
- *1: 关于 tмськ,参考 "(2)源时钟/机器时钟"。
- *2: 振荡器的振荡时间是指振幅达到 90% 时的时间。晶体振荡器的振荡时间介于几个 ms 和十几 ms 之间。陶瓷振荡器的振荡时间介于几百 μ s 和几个 ms 之间。外部时钟的振荡时间为 0 ms。 CR 振荡时钟的振荡时间介于几个 μ s 和几个 ms 之间。



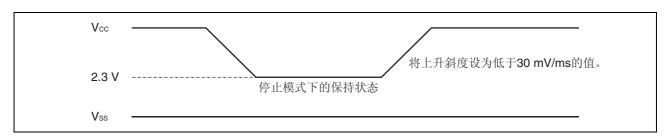
(4) 上电复位

(Vss = 0.0 V, Ta = $-40~^{\circ}\text{C} \sim +85~^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额兒	定值	单位	备注	
少 数			最小	最大	平位	一	
电源上升时间	t R	_	_	50	ms		
电源切断时间	toff	_	1	_	ms	上电前的等待时间	



注:电源电压的瞬变可能启动上电复位功能。运行期间变更电源电压时,将上升斜度设为低于 30 mV/ms 的值,参考下图。

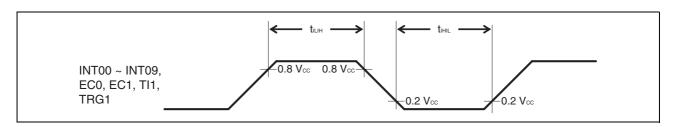


(5) 外围输入时序

(Vcc = 5.0 V±10%, Vss = 0.0 V, T_A = -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C)

会業。	符号	PI HU 夕 和	额是	单位	
参数	付与	引脚名称	最小	最大	华 仏
外围输入 "H" 脉宽	tılıн	INT00 ~ INT09, EC0, EC1,TI1,	2 t mclk*	_	ns
外围输入 "L" 脉宽	tıнıL	TRG1	2 t мськ*	_	ns

^{*} 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟 "。



(6) LIN-UART 时序

在采样时钟的上升沿执行采样 *1, 禁止串行时钟延时 *2。 (ESCR 寄存器: SCES 位 = 0, ECCR 寄存器: SCDE 位 = 0)

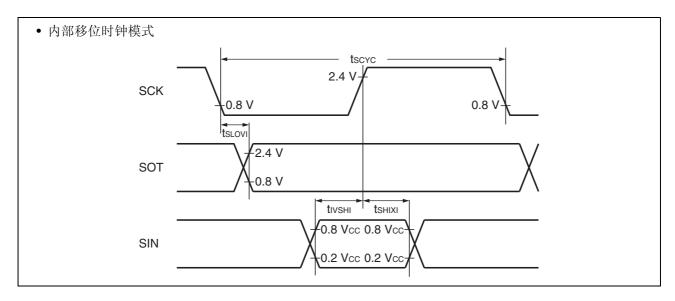
 $(Vcc = 5.0 \text{ V} \pm 10\%, \text{ AVss} = \text{Vss} = 0.0 \text{ V}, \text{ Ta} = -40 ^{\circ}\text{C} \sim +5 ^{\circ}\text{C})$

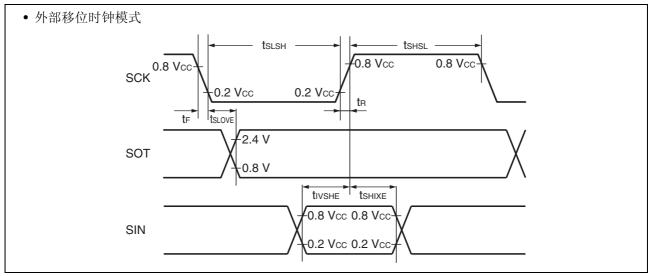
会业	hh D	可明点和	<i>b</i> /4-	额兒	 定值	单位
参数	符号	引脚名称	条件	最小	最大	甲位
串行时钟周期时间	tscyc	SCK		5 t мськ* ³	_	ns
SCK ↓ → SOT 延迟时间	tslovi	SCK, SOT	内部时钟工作 输出引脚:	-95	+95	ns
有效 SIN → SCK ↑	tıvsнı	SCK, SIN	CL = 80 pF + 1 TTL	tмськ*3 + 190	_	ns
SCK↑→有效 SIN 保持时间	tshixi	SCK, SIN		0	_	ns
串行时钟 "L" 脉宽	t slsh	SCK		3 tмськ*3 — tr	_	ns
串行时钟 "H" 脉宽	t shsl	SCK		tмськ*3 + 95	_	ns
SCK ↓ → SOT 延迟时间	t slove	SCK, SOT	外部时钟工作	_	2 tmclk*3 + 95	ns
有效 SIN → SCK ↑	tivshe	SCK, SIN	输出引脚:	190	_	ns
SCK↑→有效 SIN 保持时间	t shixe	SCK, SIN	$C_L = 80 \text{ pF} + 1 \text{ TTL}$	tмськ*3 + 95	_	ns
SCK 下降时间	t⊧	SCK		_	10	ns
SCK 上升时间	t⊓	SCK		_	10	ns

^{*1:} 采样时钟具有选择在串行时钟的上升沿或下降沿对接收数据进行采样的功能。

^{*2:} 串行时钟延时功能用于延迟串行时钟输出信号的半个时钟周期。

^{*3:} 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟"。





在采样时钟的下降沿执行采样 *1 ,禁止串行时钟延时 *2 。 (ESCR 寄存器: SCES 位 = 1, ECCR 寄存器: SCDE 位 = 0)

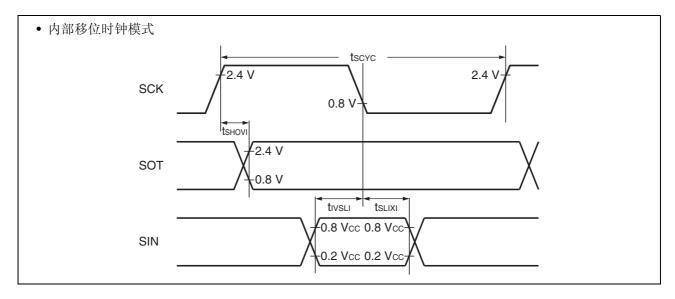
 $(V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 10\%, \text{ Vss} = 0.0 \text{ V}, \text{ Ta} = -40 ^{\circ}\text{C} \sim +85 ^{\circ}\text{C})$

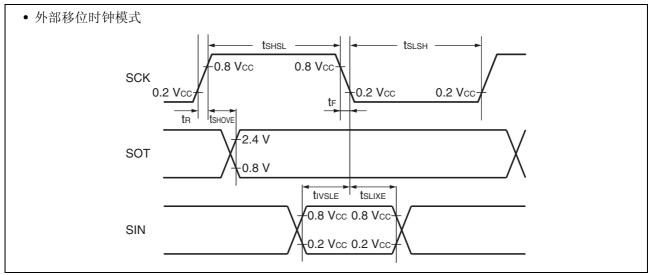
♦₩	hh □	可明力场	发 (4)	额兒	定值	单位	
参数	符号	引脚名称 	条件	最小	最大	平位	
串行时钟周期时间	tscyc	SCK		5 t мськ* ³		ns	
SCK ↑ → SOT 延迟时间	t shovi	SCK, SOT	内部时钟工作 输出引脚:	-95	+95	ns	
有效 SIN → SCK ↓	tıvslı	SCK, SIN	加山 7 DAP . CL = 80 pF + 1 TTL	tмськ*3 + 190	_	ns	
SCK ↓ → 有效 SIN 保持时间	t slixi	SCK, SIN		0		ns	
串行时钟 "H" 脉宽	t shsl	SCK		3 tмськ*3 — tr		ns	
串行时钟 "L" 脉宽	t slsh	SCK		tмськ*3 + 95		ns	
SCK ↑ → SOT 延迟时间	t shove	SCK, SOT	外部时钟工作	_	2 tmclk*3 + 95	ns	
有效 SIN → SCK ↓	tivsle	SCK, SIN	输出引脚:	190		ns	
SCK ↓ → 有效 SIN 保持时间	tslixe	SCK, SIN	$C_L = 80 pF + 1 TTL$	tмськ*3 + 95	_	ns	
SCK 下降时间	t⊧	SCK			10	ns	
SCK 上升时间	t⊓	SCK		_	10	ns	

^{*1:} 采样时钟具有选择在串行时钟的上升沿或下降沿对接收数据进行采样的功能。

^{*2:} 串行时钟延时功能用于延迟串行时钟输出信号的半个时钟周期。

^{*3:} 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟 "。



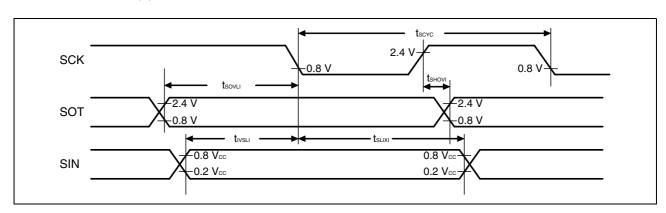


在采样时钟的上升沿执行采样 *1 ,使能串行时钟延时 *2 。 (ESCR 寄存器: SCES 位 = 0, ECCR 寄存器: SCDE 位 = 1)

(Vcc = 5.0 V±10%, Vss = 0.0 V, TA = -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C)

会粉	符号	引脚名称	条件	额知	建值	单位
参数	切ら	り四名物	余什	最小	最大	半仏
串行时钟周期时间	tscyc	SCK		5 t мськ* ³	_	ns
SCK ↑ → SOT 延迟时间	t shovi	SCK, SOT	内部时钟工作	-95	+95	ns
有效 SIN → SCK ↓	tıvslı	SCK, SIN	输出引脚:	tмськ*3 + 190	_	ns
SCK ↓ → 有效 SIN 保持时间	tslixi	SCK, SIN	C _L = 80 pF + 1 TTL	0	_	ns
SOT → SCK ↓ 延迟时间	t sovli	SCK, SOT		_	4 tmclk*3	ns

- *1: 采样时钟具有选择在串行时钟的上升沿或下降沿对接收数据进行采样的功能。
- *2: 串行时钟延时功能用于延迟串行时钟输出信号的半个时钟周期。
- *3: 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟"。



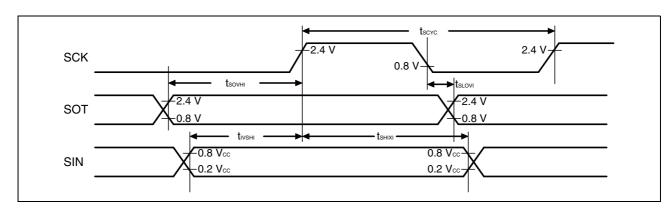
在采样时钟的下降沿执行采样*1,使能串行时钟延时*2。

(ESCR 寄存器: SCES 位 = 1, ECCR 寄存器: SCDE 位 = 1)

 $(V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 10\%, V_{SS} = 0.0 \text{ V}, T_{A} = -40 ^{\circ}\text{C} ^{\sim} + 85 ^{\circ}\text{C})$

参数	符号	引脚名称	条件	额知	E值	单位
少 数	177	11四石110	家 什	最小	最大	半世
串行时钟周期时间	tscyc	SCK		5 t мськ* ³	_	ns
SCK ↓ → SOT 延迟时间	tslovi	SCK, SOT	内部时钟工作	-95	+95	ns
有效 SIN → SCK ↑	t ıvshı	SCK, SIN	输出引脚:	tmclk*3 + 190	_	ns
SCK↑→有效 SIN 保持时间	t shixi	SCK, SIN	C _L = 80 pF + 1 TTL	0	_	ns
SOT → SCK ↑ 延迟时间	tsovнı	SCK, SOT		_	4 tmcLK*3	ns

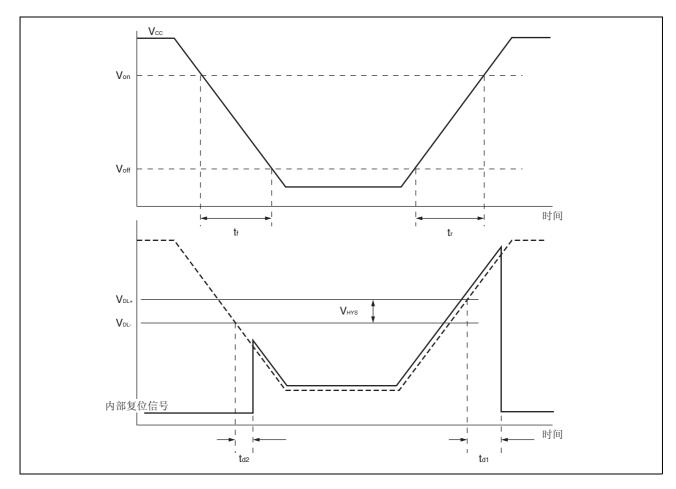
- *1: 采样时钟具有选择在串行时钟的上升沿或下降沿对接收数据进行采样的功能。
- *2: 串行时钟延时功能用于延迟串行时钟输出信号的半个时钟周期。
- *3: 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟 "。



(7) 低压检测

(Vss = 0.0 V, Ta = -40 $^{\circ}\mathrm{C}$ ~ +85 $^{\circ}\mathrm{C}$)

⇔ ₩-	<i>7</i> /2 □.		额定值		* *	Ø X)
参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
释放电压	V_{DL^+}	2.52	2.7	2.88	V	电源上升时
检测电压	V _D Λ-	2.42	2.6	2.78	V	电源下降时
迟滞宽度	VHYS	70	100		mV	
电源起始电压	Voff	_	_	2.3	V	
电源结束电压	Von	4.9	_		V	
电源电压变更时间 (电源上升时)	tr	3000	_	_	μs	内复位解除信号在额定范围 (VDL+) 内产生的电源斜度
电源电压变更时间 (电源下降时)	tf	300	_	_	μs	复位检测信号在额定范围 (VDL-) 内产生的电源斜度
复位解除延迟时间	t d1			300	μs	
复位检测延迟时间	t d2	_	_	20	μs	

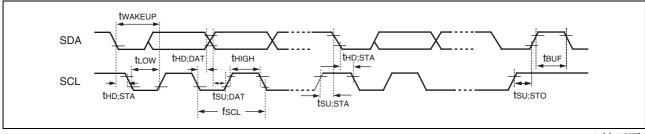


(8) I²C 时序

(Vcc = 5.0 V±10%, AVss = Vss = 0.0 V, T_A = -40 °C ~ +85 °C)

						单位		
参数	符号	引脚名称	条件	标准模式		快速模式		単 位
				最小	最大	最小	最大	
SCL 时钟频率	fscL	SCL		0	100	0	400	kHz
(重复) START 状态保持时间 SDA ↓ → SCL ↓	thd;sta	SCL, SDA	R = 1.7 kΩ,	4.0	_	0.6	_	μs
SCL 时钟 "L" 宽度	tLOW	SCL		4.7	_	1.3	_	μs
SCL 时钟 "H" 宽度	tніgн	SCL		4.0	_	0.6	_	μs
(重复)START 状态保持时间 SCL↑→SDA↓	tsu;sta	SCL, SDA		4.7	_	0.6		μs
数据保持时间 SCL ↓ → SDA ↓↑	t hd;dat	SCL, SDA	$C = 50 \text{ pF}^{*1}$	0	3.45*2	0	0.9*3	μs
数据设定时间 SDA ↓↑ → SCL ↑	tsu;dat	SCL, SDA		0.25	_	0.1		μs
STOP 状态设定时间 SCL ↑ → SDA ↑	t su;sто	SCL, SDA		4	_	0.6	_	μs
STOP 状态和 START 状态间的总线 空闲时间	tbuf	SCL, SDA		4.7	_	1.3	_	μs

- *1: R 代表 SCL 和 SDA 线的上拉电阻器, C 代表 SCL 和 SDA 线的负载电容器。
- *2: 仅在 "L"(tLow) 时器件保持 SCL 信号的时间不延长的场合,适用标准模式时的最大 tho;DAT。
- *3: 如果满足条件 tsu;par ≥ 250 ns,则可在标准模式下使用快速模式 I²C 总线器件。



(Vcc = 5.0 V±10%, AVss = Vss = 0.0 V, Ta = –40 $^{\circ}\mathrm{C}$ ~ +85 $^{\circ}\mathrm{C}$)

参数	符号	引脚	友件	额定	值 *2	单位	备注	
少 数	117.2	名称	条件	最小	最大	平位.	金 往	
SCL 时钟 "L" 宽度	tLOW	SCL		(2 + nm/2)tmclk - 20	_	ns	主控模式	
SCL 时钟 "H" 宽度	t HIGH	SCL			(nm/2)tмськ — 20	(nm/2)t _{MCLK} + 20	ns	主控模式
START 状态 保持时间	thd;sta	SCL, SDA		(-1 + nm/2)tмсLк - 20	(-1 + nm)tmclk + 20	ns	主控模式 m, n = 1, 8 时, 应用最大值。其 他场合下应用最 小值。	
STOP 状态设 定时间	t su;sто	SCL, SDA		(1 + nm/2)tмськ — 20	(1 + nm/2)tмсLк + 20	ns	主控模式	
START 状态 设定时间	t su;sta	SCL, SDA		(1 + nm/2)tмсLк — 20	(1 + nm/2)tmclk + 20	ns	主控模式	
STOP 状态和 START 状态 间的总线空闲 时间	tвиғ	SCL, SDA	$R = 1.7 \text{ k}\Omega,$ $C = 50 \text{ pF}^{*1}$	(2 nm + 4)t _{MCLK} - 20	_	ns		
数据保持时间	thd;dat	SCL, SDA		3 tмськ — 20	_	ns	主控模式	
数据设定时间	tsu;dat	SCL, SDA		(-2 + nm/2)tмсLк - 20	(-1 + nm/2)tмсLк + 20	ns	主控模式 未延长 SCL 的 "L" 时,将最小值 应用到连续数据 的第一位。其他 场合下应用最大 值。	
清零中断和 SCL 上升间 的设定时间	tsu;ınt	SCL		(nm/2)tmclk — 20	(1 + nm/2)tmcLk + 20	ns	在第 9 个 SCL↓ 将最小值应用到 中断。在第 8 个 SCL↓将最大值 应用到中断。	

(转下页)

(承上页)

 $(Vcc = 5.0 V \pm 10\%, AVss = Vss = 0.0 V, T_A = -40 ^{\circ}C \sim +85 ^{\circ}C)$

<u>ئى بىد</u>	<i>₩</i> . □	引脚	Ar III.	称定值			Ø >}-
参数	符号	名称	条件	最小	最大	单位	备注
SCL 时钟 "L" 宽度	tLOW	SCL		4 tмськ — 20	_	ns	接收时
SCL 时钟 "H" 宽度	tніgн	SCL			_	ns	接收时
START 状态检测	t hd;sta	SCL, SDA		2 tmclk — 20	_	ns	接收时使用 1 tmclk 的场合,未检出 START 状态。
STOP 状态检测	tsu;sто	SCL, SDA		2 tmclk — 20	_	ns	接收时使用 1 t MCLK 的场合,未检出 STOP 状态。
RESTART 状态检测	tsu;sta	SCL, SDA		2 tmclk — 20	_	ns	接收时使用 1 tmcLK 的场合,未检出 RE START 状态。
总线空闲时间	t BUF	SCL, SDA	$R = 1.7 \text{ k}\Omega,$ $C = 50 \text{ pF}^{*1}$	2 tmcLK — 20	_	ns	接收时
数据保持时间	thd;dat	SCL, SDA		2 tmcLK — 20	_	ns	从动发送模式时
数据设定时间	tsu;dat	SCL, SDA		tьоw — 3 tмськ — 20	_	ns	从动发送模式时
数据保持时间	thd;dat	SCL, SDA		0	_	ns	接收时
数据设定时间	t su;dat	SCL, SDA		tмськ — 20	_	ns	接收时
SDA↓ → SCL↑ (唤醒功能时)	twakeup	SCL, SDA		振荡稳定等待 时间 +2 tмск – 20	_	ns	

- *1: R 代表 SCL 和 SDA 线的上拉电阻器,C 代表 SCL 和 SDA 的负载电容器。
- *2 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟 "。
 - m 代表 I²C 时钟控制寄存器 (ICCR0) 的 CS4 位和 CS3 位 (位 4 和位 3)。
 - n 代表 I²C 时钟控制寄存器 (ICCR0) 的 CS2 位 ~ CS0 位 (位 2 ~ 位 0)。
 - I2C 的实际时序取决于机器时钟 (tmclk) 和 ICCRO 寄存器的 CS4 ~ CSO 位所设定 m 和 n 的值。
 - 标准模式。

m 和 n 的设定范围如下: 0.9 MHz < tмськ (机器时钟) < 10 MHz。

机器时钟的可用频率取决于 m 和 n 的设定,详细如下:

(m, n) = (1, 8) : 0.9 MHz < tmclk ≤ 1 MHz

(m, n) = (1, 22), (5, 4), (6, 4), (7, 4), (8, 4) : 0.9 MHz < tmclk \leq 2 MHz

(m, n) = (1, 38), (5, 8), (6, 8), (7, 8), (8, 8) : $0.9 \text{ MHz} < t_{MCLK} \le 4 \text{ MHz}$ (m, n) = (1, 98) : $0.9 \text{ MHz} < t_{MCLK} \le 10 \text{ MHz}$

• 快速模式:

m 和 n 的设定范围如下: 3.3 MHz < tмсLκ (机器时钟) < 10 MHz。

机器时钟的可用频率取决于 m n n 的设定,详细如下:(m,n) = (1,8) 3.3 $MHz < t_{MOLK} \le 4$ MHz

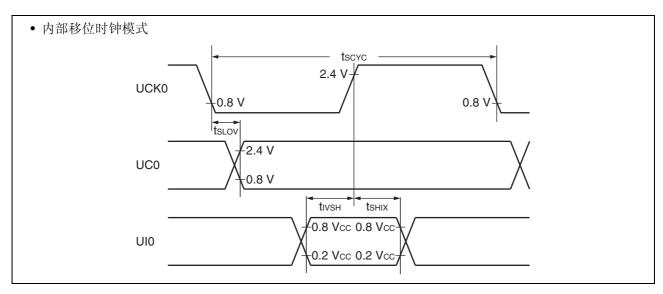
 $\begin{array}{ll} (m,\,n) = (1,\,8) & : 3.3 \; \text{MHz} < t_{\text{MCLK}} \le 4 \; \text{MHz} \\ (m,\,n) = (1,\,22),\,(5,\,4) & : 3.3 \; \text{MHz} < t_{\text{MCLK}} \le 8 \; \text{MHz} \\ (m,\,n) = (6,\,4) & : 3.3 \; \text{MHz} < t_{\text{MCLK}} \le 10 \; \text{MHz} \end{array}$

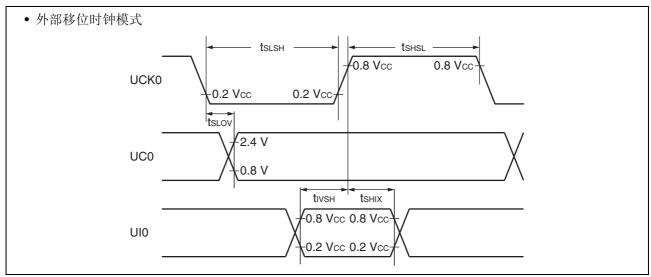
(9) UART/SIO, 串行 I/O 时序

 $(Vcc = 5.0 V \pm 10\%, AVss = Vss = 0.0 V, T_A = -40 °C \sim +85 °C)$

			4. 11	额知	 定值	\ ,, ,, \(\)	
参数	符号	引脚名称	条件	最小	最大	┩単位┃	
串行时钟周期时间	tscyc	UCK0		4 tmclk*	_	ns	
UCK ↓ → UO 时间	tslov	UCK0, UO0		-190	+190	ns	
有效 UI → UCK ↑	tıvsн	UCK0, UI0	内部时钟工作	2 tmclk*	_	ns	
UCK↑→有效 UI 保持时间	t sHIX	UCK, UI0		2 tmclk*	_	ns	
串行时钟 "H" 脉宽	tshsl	UCK0		4 tmclk*	_	ns	
串行时钟 "L" 脉宽	tslsн	UCK0		4 tmclk*	_	ns	
UCK ↓ → UO 时间	tsLov	UCK0, UO0	外部时钟工作	_	190	ns	
有效 UI → UCK ↑	tıvsн	UCK0, UI0		2 tmclk*	_	ns	
UCK↑→有效 UI 保持时间	tsнıx	UCK0, UI0		2 tmclk*	_	ns	

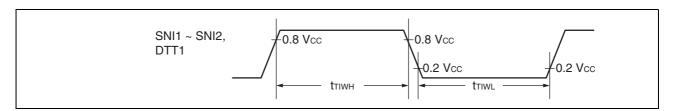
^{*:} 关于 tmclk,参考 "(2)源时钟/机器时钟 "。





(10) MPG 输入时序

$(V_{CC} = 5.0 \text{ V} \pm 10\%, \text{ AV}_{SS} = \text{V}_{SS} = 0.0 \text{ V}, \text{ T}_{A} = -40 ^{\circ}\text{C} \sim +85 ^{\circ}\text{C}$							℃ ~ +85 ℃)
参数	 符号 	引脚名称	条件	额定值		单位	夕沪
少 数			余件	最小	最大	半仏	备注
输入脉宽	tтıwн tтıwL	SNI0 ~ SNI2, DTTI	_	4 tmclk	_	ns	



5. A/D 转换器

(1) A/D 转换器的电气特性

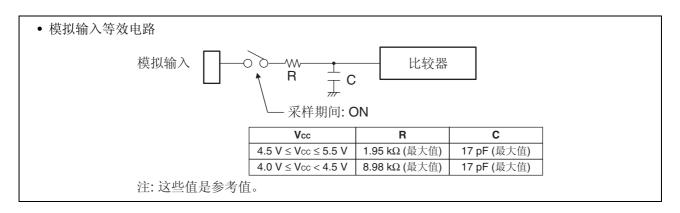
(Vcc = 4.0 V \sim 5.5 V, Vss = 0.0 V, Ta = –40 $^{\circ}\mathrm{C}$ \sim +85 $^{\circ}\mathrm{C}$)

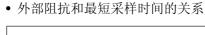
			•			·
	符号	额定值				A >4-
多 数		最小	典型	最大	单位	备注
分辨率		_	_	10	bit	
总误差		-3	_	+3	LSB	
线性误差		-2.5	_	+2.5	LSB	
微分线性误差		-1.9	_	+1.9	LSB	
零转换电压	Vот	Vss – 1.5 LSB	Vss + 0.5 LSB	Vss + 2.5 LSB	V	
全面转换电压	V _{FST}	Vcc – 4.5 LSB	Vcc – 2 LSB	Vcc + 0.5 LSB	V	
11/4六日 日	_	0.9	_	16500	μs	4.5 V ≤ Vcc ≤ 5.5 V
比较时间		1.8	_	16500	μs	4.0 V ≤ Vcc < 4.5 V
立林中伫	_	0.6	_	•	μs	4.5 V ≤ Vcc ≤ 5.5 V, 外部阻抗 < 5.4 kΩ
采样时间		1.2	_	•	μs	4.0 V ≤ Vcc < 4.5 V, 外部阻抗 < 2.4 kΩ
模拟输入电流	Iain	-0.3	_	+0.3	μΑ	
模拟输入电压	Vain	Vss	_	Vcc	V	

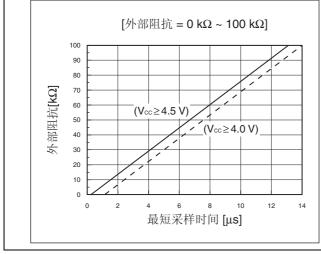
(2) A/D 转换器的使用注意事项

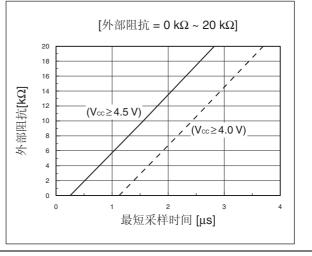
• 模拟输入及其采样时间的外部阻抗

• A/D 转换器具有采样和保持电路。若外部阻抗太高,无法保持充分的采样时间,则导致内部采样和保持电路电容器的模拟输入电压不足,反而影响 A/D 转换精度。因此,为满足 A/D 转换精度标准,需考虑外部阻抗和最短采样时间的关系,调整寄存器值和工作频率或降低外部阻抗以使采样时间大于最小值。另外,若仍不能保证充分的采样时间,应在模拟输入引脚处连接一个约 0.1 μF 的电容器。









• A/D 转换器误差

A/D 转换误差的变化和 IVcc - Vssl 成反比。

(3) A/D 转换器术语定义

• 分辨率

是指 A/D 转换器能够分辨的模拟偏差等级。

位数为 10 时,模拟电压可分解为 210 = 1024。

• 线性误差 (单位: LSB)

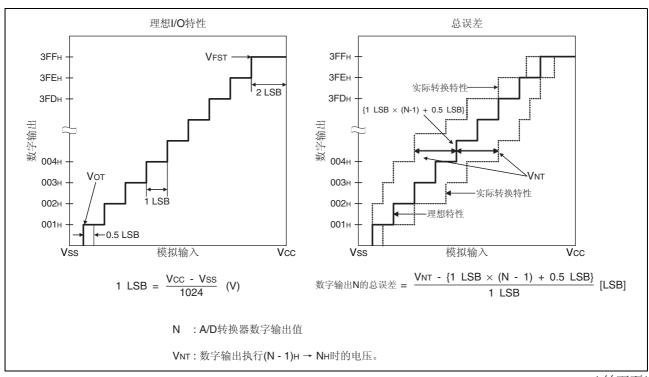
是指实际转换值偏离直线的误差。该直线连接器件的零转换点 ("00 0000 0000" $\leftarrow \rightarrow$ "00 0000 0001") 至同一器件的全面转换点 ("11 1111 1111" $\leftarrow \rightarrow$ "11 1111 1110")。

• 微分线性误差 (单位: LSB)

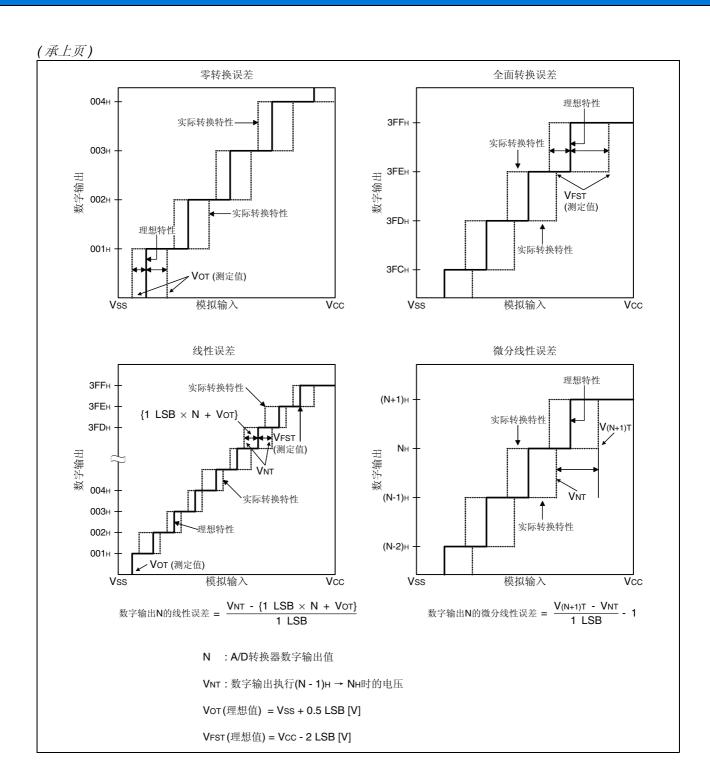
是指使用 1 个 LSB 改变输出码所需的输入电压偏离理想值的误差。

• 总误差 (单位: LSB)

是指实际值和理论值之间的误差。总误差由零转换误差、完全转换误差、线性误差、量子误差或噪声引起。



(转下页)



6. 闪存写/擦特性

参数	额定值			* *	A 33-	
	最小	典型	最大	单位	备注	
扇区擦除时间 (2 KB 扇区)	_	0.2*1	0.5*2	s	不含擦除前 00н 的写入时间。	
扇区擦除时间 (16 KB 扇区)	_	0.5*1	7.5*2	s	不含擦除前 00н 的写入时间。	
字节写入时间		21	6100*2	μs	不含系统级管理时间。	
擦/写周期	100000	_	_	周		
擦/写时的电源电压	3.0	_	5.5	V		
闪存数据保持时间	20*3	_	_	年	平均 T _A = +85 ℃	

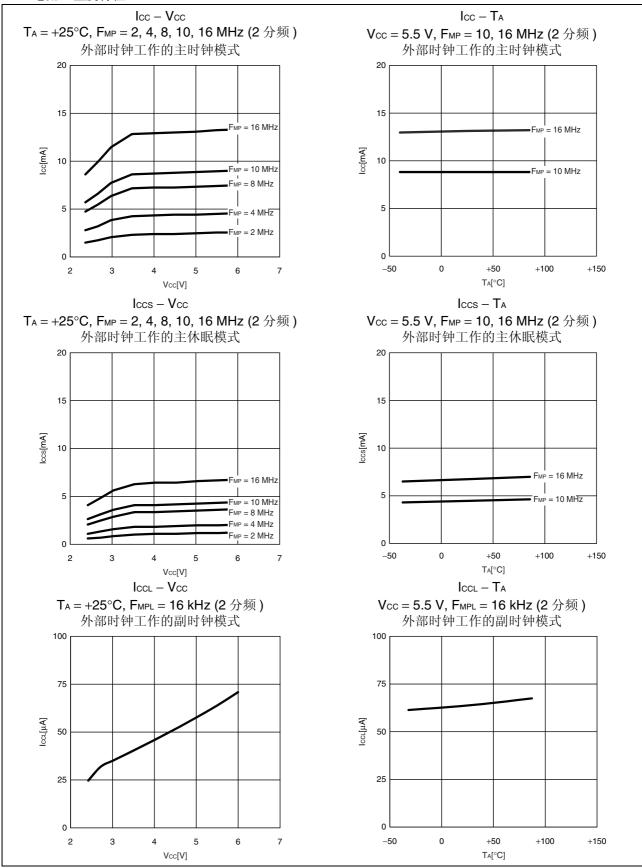
^{*1:} Ta = +25 $^{\circ}\mathrm{C}$, Vcc = 5.0 V, 100000 周

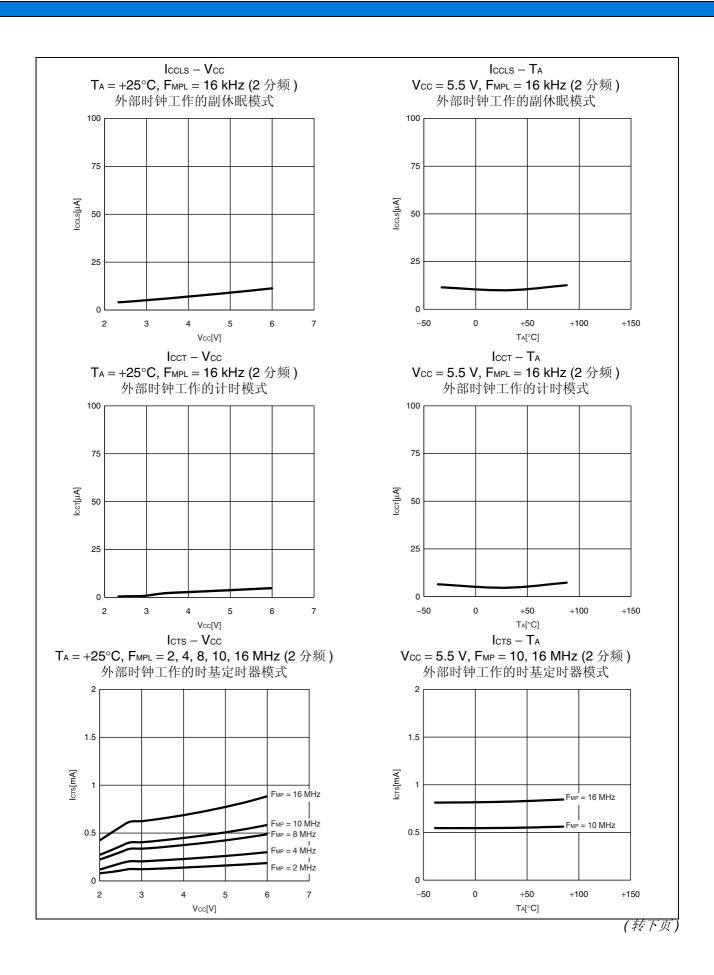
^{*2:} Ta = +85 $^{\circ}\mathrm{C}$, Vcc = 3.0 V, 100000 周

^{*3:} 该值源于技术可靠性评估结果转换而来。 (该值是在平均温度 +85 ℃的条件下使用 Arrhenius 方程进行高温加速测试的结果转换而来)

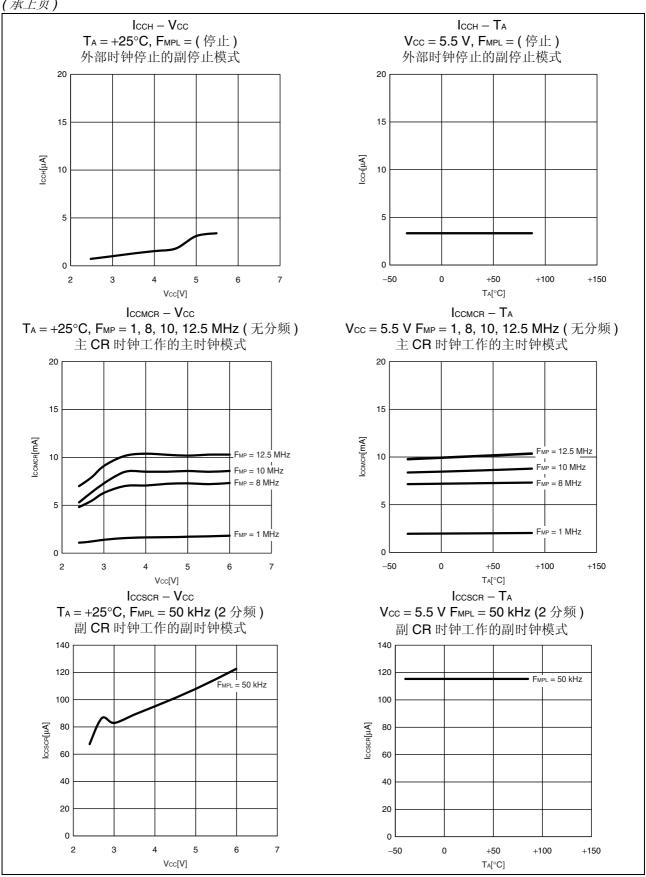
■ 电气特性示图

• 电流 - 温度特性

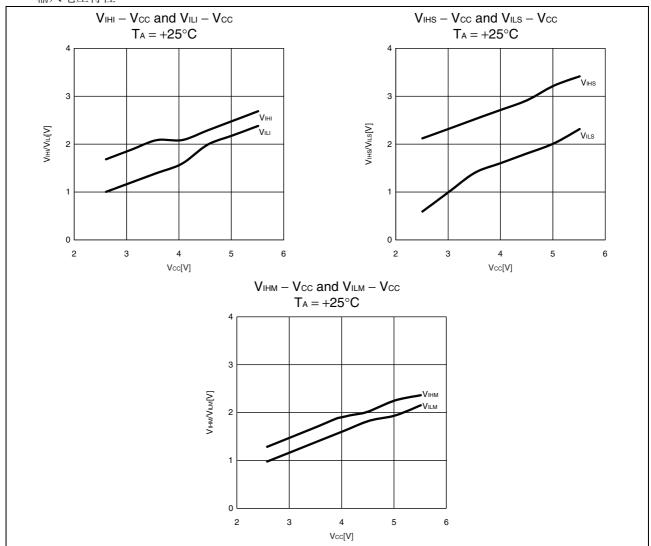




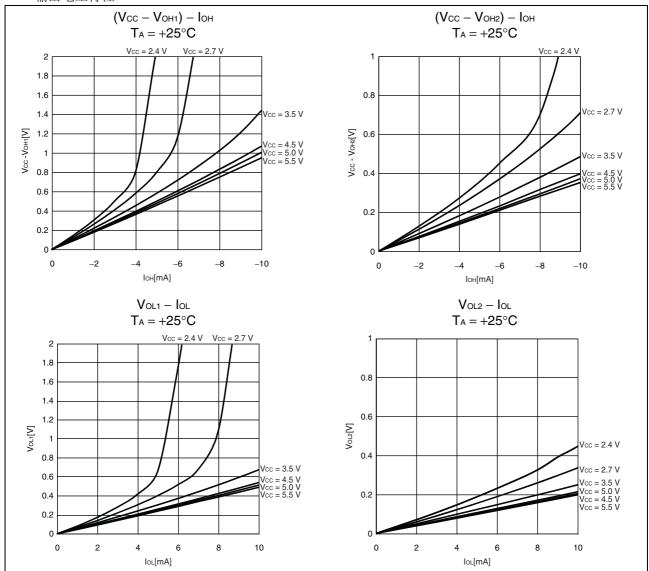




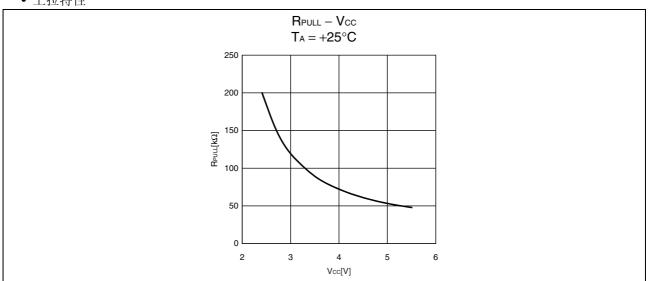
• 输入电压特性



• 输出电压特性



• 上拉特性



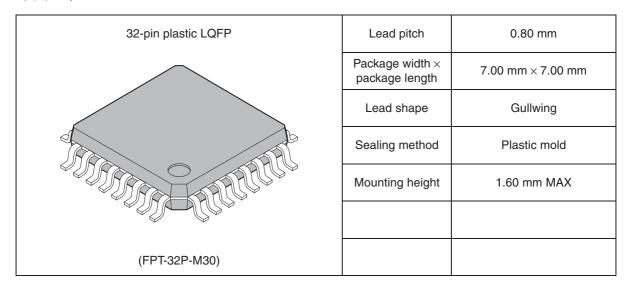
■ 掩膜选项

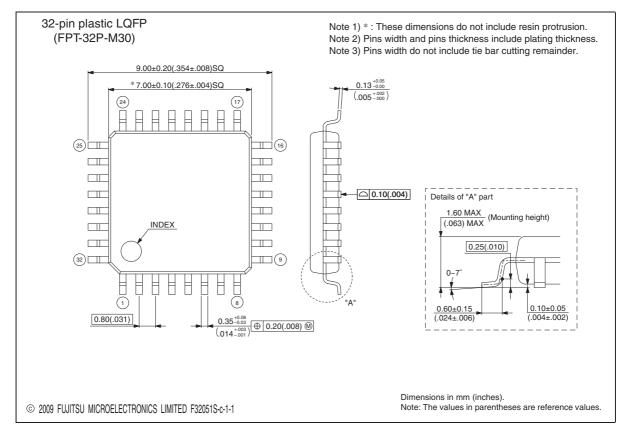
序号	产品型号	MB95F332H MB95F333H MB95F334H	MB95F332K MB95F333K MB95F334K				
	可选/固定	固定					
1	低压检测复位	无低压检测复位	有低压检测复位				
2	复位	有专用复位输入	无专用复位输入				

■ 订购信息

产品型号	封装
MB95F332HPMC-G-SNE2 MB95F332KPMC-G-SNE2 MB95F333HPMC-G-SNE2 MB95F333KPMC-G-SNE2 MB95F334HPMC-G-SNE2 MB95F334KPMC-G-SNE2	32 脚塑料封装 LQFP (FPT-32P-M30)
MB95F332HP-G-SH-SNE2 MB95F332KP-G-SH-SNE2 MB95F333HP-G-SH-SNE2 MB95F333KP-G-SH-SNE2 MB95F334HP-G-SH-SNE2 MB95F334KP-G-SH-SNE2	32 脚塑料封装 SH-DIP (DIP-32P-M06)
MB95F332HWQN-G-SNE1 MB95F332KWQN-G-SNE1 MB95F333HWQN-G-SNE1 MB95F333KWQN-G-SNE1 MB95F334HWQN-G-SNE1 MB95F334KWQN-G-SNE1	32 脚塑料封装 QFN (LCC-32P-M19)

■ 封装尺寸



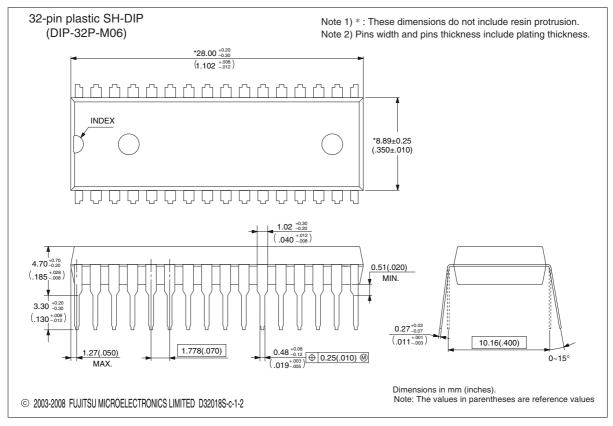


请访问以下网页获取最新封装信息:

http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/

(转下页)

32-pin plastic SH-DIP	Lead pitch	1.778 mm
	Low space	10.16 mm
	Sealing method	Plastic mold
U V		
(DIP-32P-M06)		

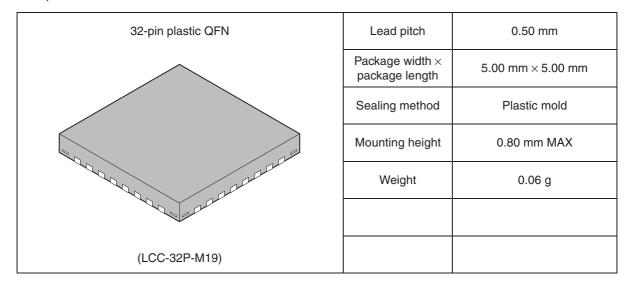


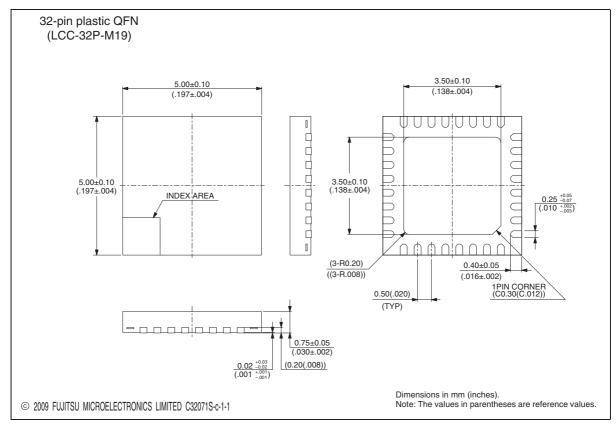
请访问以下网页获取解最新封装信息:

http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/

(转下页)

(承上页)





请访问以下网页获取最新封装信息:

http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/

FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED

Nomura Fudosan Shin-yokohama Bldg. 10-23, Shin-yokohama 2-Chome,

Kohoku-ku Yokohama Kanagawa 222-0033, Japan

Tel: +81-45-415-5858 http://jp.fujitsu.com/fsl/en/

联系我们:

North and South America

FUJITSU MICROELECTRONICS AMERICA, INC. 1250 E. Arques Avenue, M/S 333 Sunnyvale, CA 94085-5401, U.S.A. Tel: +1-408-737-5600 Fax: +1-408-737-5999 http://www.fma.fujitsu.com/

Europe

FUJITSU MICROELECTRONICS EUROPE GmbH Pittlerstrasse 47, 63225 Langen, Germany Tel: +49-6103-690-0 Fax: +49-6103-690-122 http://emea.fujitsu.com/microelectronics/

Korea

FUJITSU MICROELECTRONICS KOREA LTD. 206 Kosmo Tower Building, 1002 Daechi-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-280, Republic of Korea Tel: +82-2-3484-7100 Fax: +82-2-3484-7111 http://kr.fujitsu.com/fmk/

Asia Pacific

FUJITSU MICROELECTRONICS ASIA PTE. LTD. 151 Lorong Chuan, #05-08 New Tech Park 556741 Singapore Tel: +65-6281-0770 Fax: +65-6281-0220 http://www.fmal.fujitsu.com/

FUJITSU MICROELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD. Rm. 3102, Bund Center, No.222 Yan An Road (E), Shanghai 200002, China
Tel: +86-21-6146-3688 Fax: +86-21-6335-1605
http://cn.fujitsu.com/fmc/

FUJITSU MICROELECTRONICS PACIFIC ASIA LTD. 10/F., World Commerce Centre, 11 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2377-0226 Fax: +852-2376-3269

http://cn.fujitsu.com/fmc/en/

规格若有变动,恕不另行通知。欲了解详细信息,请联系各地的事务所。

版权所有

本手册的记载内容如有变动, 恕不另行通知。

建议用户订购前先咨询销售代表。

本手册记载的信息仅作参考,诸如功能概要和应用电路示例,旨在说明 FUJITSU SEMICONDUCTOR 半导体器件的使用方法和操作示例。对于建立在该信息基础上的器件使用,FUJITSU SEMICONDUCTOR 不保证器件的正常工作。如果用户根据该信息在开发产品中使用该器件,用户应对该信息的使用负责。基于上述信息的使用引起的任何损失,FUJITSU SEMICONDUCTOR 概不承担任何责任。

本手册内的任何信息,包括功能介绍和原理图,不应理解为使用和执行任何知识产权的许可,诸如专利权或著作权,或 FUJITSU SEMICONDUCTOR 的其他权利或第三方权利, FUJITSU SEMICONDUCTOR 也不保证使用该信息不侵犯任何第三方知识产权或其他权利。因使用该信息引起的第三方知识产权或其他权利的侵权行为, FUJITSU SE MICONDUCTOR 不承担任何责任。

本手册所介绍的产品旨在一般用途而设计、开发和制造,包括但并不限于一般的工业使用、通常办公使用、个人使用和家庭使用。在以下设计、开发和制造 (1) 使用中伴随着致命风险或危险,若不加以特别高度安全保障,有可能导致对公众产生危害,甚至直接死亡、人身伤害、严重物质损失或其他损失 (即核设施的核反应控制、航空飞行控制、空中交通控制、公共交通控制、医用维系生命系统、核武器系统的导弹发射控制),(2)需要极高可靠性的应用领域(比如海底中转器和人造卫星)。

注意上述领域内使用该产品引起的用户和/或第三方的任何索赔或损失,FUJITSU SEMICONDUCTOR不承担任何责任。半导体器件存在一定的故障发生概率。请用户对器件和设备采取冗余设计、消防设计、过电流等级防护措施,其他异常操作防护措施等安全设计,保证即使半导体器件发生故障的情况下,也不会造成人身伤害、社会损害或重大损失。本手册内记载的任何产品的出口/发布可能需要根据日本外汇及外贸管理法和/或美国出口管理法条例办理必要的手续。本手册内记载的公司名称和商标名称是各个公司的商标或注册商标。

编辑:销售促进部